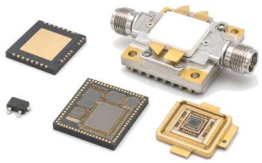
Produktkatalog

# RF-ICs, MMICs und Halbleiterbauelemente

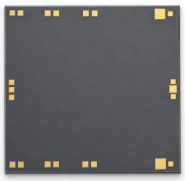
Aktive RF-Bausteine für Verstärkung, Umsetzung, Schalten, Detektion, Steuerung und Frequenzaufbereitung, nach Funktion geordnet und bei modellspezifischen Angaben streng nach Nachweis geführt.



Produkte: 315

Revision: 28 · Revisionsdatum: 2026-11-12

## RF-MMIC-Verstärker



### LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

**11500–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die**

GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für Mikrowellen-Sendestufen von 11,5 bis 18 GHz. Beide HF-Signalpfade besitzen eine Gleichstromsperre. Der Chip unterstützt CW- und Pulsbetrieb.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 11500; Maximum: 18000; Wert: 11500–18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 19.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

**14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die**

Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (Minimum) / 42.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (Minimum) / 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 35 % (Minimum). Chipabmessungen: 3 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 42; Typisch: 42.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-14200-16800-PS48T

### 14200–16800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14200; Maximum: 16800; Wert: 14200–16800; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-14500-17200-PS48T

### 14500–17200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14500; Maximum: 17200; Wert: 14500–17200; Einheit: MHz

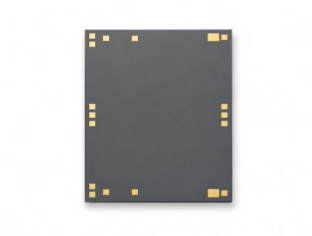
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

### 13750–14500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (Minimum); Leistungsverstärkung: 20 dB (Minimum); PAE: 37 % (Minimum) / 38 % (typisch). Chipabmessungen: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13750; Maximum: 14500; Wert: 13750–14500; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13750-15250-PS46T

### 13750–15250 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Sättigungsausgangsleistung: 46 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 5 × 6 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 13750; Maximum: 15250; Wert: 13750–15250; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 46; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (Minimum) / 48.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 23 dB (Minimum) / 23.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 44 % (typisch). Chipabmessungen: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 48; Typisch: 48.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 23; Typisch: 23.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

### 13800–18200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 47 dBm (Minimum) / 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (Minimum) / 21.5 dB (typisch); PAE: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13800; Maximum: 18200; Wert: 13800–18200; Einheit: MHz

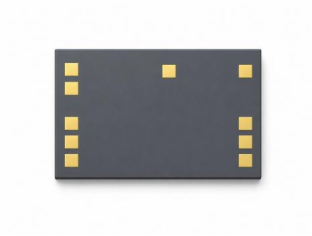
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 21.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

### 14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 37 dBm (Minimum) / 37.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 15 dB (Minimum) / 15.5 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 37; Typisch: 37.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 15; Typisch: 15.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

### 12200–16000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 46 dBm (Minimum) / 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 19.5 dB (typisch); PAE: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 12200; Maximum: 16000; Wert: 12200–16000; Einheit: MHz

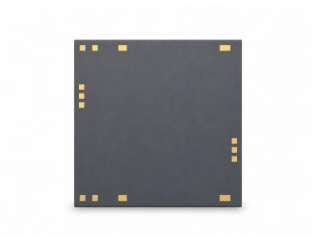
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 19.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

### 26000–40000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Leistungsverstärkung: 15 dB (typisch); PSAT: 40.5 dBm (typisch); PAE: 23 % (typisch). Chipabmessungen: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 26000; Maximum: 40000; Wert: 26000–40000; Einheit: MHz

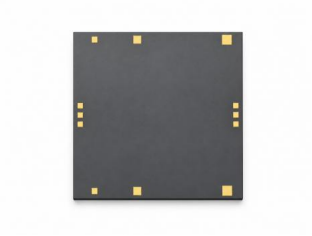
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 22; Einheit: dB

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 15; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-31000-37000-PS41T

### 31000–37000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 21 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 31000; Maximum: 37000; Wert: 31000–37000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-33000-37000-PS45T

### 33000–37000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 45 dBm (typisch); PAE: 22 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 33000; Maximum: 37000; Wert: 33000–37000; Einheit: MHz

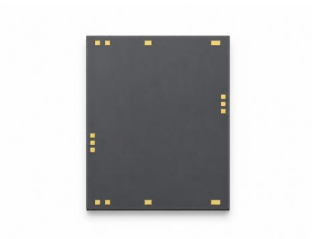
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

### 18000–40000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 40.5 dBm (typisch); PAE: 15 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 21 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 18000; Maximum: 40000; Wert: 18000–40000; Einheit: MHz

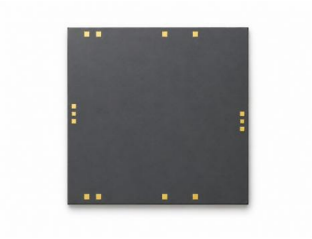
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 40.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-92000-96000-PS36T

### 92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 36 dBm (typisch); PAE: 9 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 36; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-27000-31000-PS43T

### 27000–31000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 43 dBm (typisch); PAE: 28 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 27000; Maximum: 31000; Wert: 27000–31000; Einheit: MHz

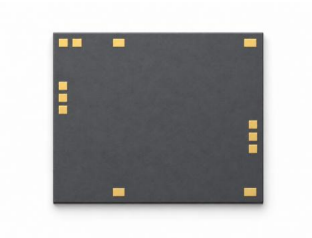
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 43; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-50000-63000-PS37T

### 50000–63000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 37 dBm (typisch); PAE: 20 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (typisch). Chipabmessungen: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 50000; Maximum: 63000; Wert: 50000–63000; Einheit: MHz

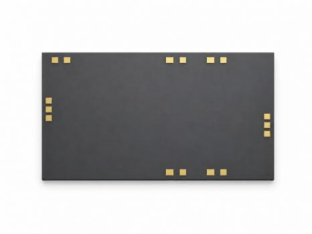
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1.5; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 37; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-92000-96000-PS34T

### 92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 34 dBm (typisch); PAE: 10 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

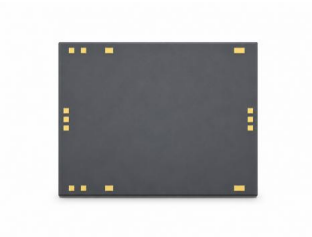
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 34; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-18000-26500-PS41T

### 18000–26500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 18000; Maximum: 26500; Wert: 18000–26500; Einheit: MHz

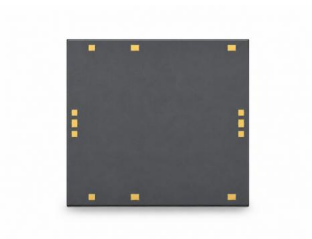
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.4; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-27000-31000-PS42T

### 27000–31000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 42 dBm (typisch); PAE: 30 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 23 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 27000; Maximum: 31000; Wert: 27000–31000; Einheit: MHz

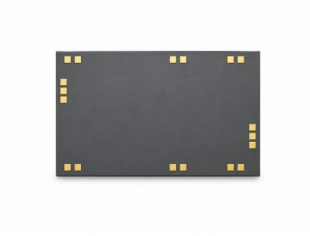
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 23; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-15000-43000-PS30T

### 15000–43000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 30 dBm (typisch); PAE: 18 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (Minimum) / 20 dB (typisch) / 22 dB (Maximum). Chipabmessungen: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 43000; Wert: 15000–43000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Minimum: 18; Typisch: 20; Maximum: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±2; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 29.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

### 92000–96000 MHz Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 26.5 dBm (typisch); PAE: 12 % (typisch) / 13 % (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 18 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 26.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

### 15000–17000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 37 % (typisch). Chipabmessungen: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 17000; Wert: 15000–17000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-12700-14500-PS47T

### 12700–14500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 46.8 dBm (Minimum) / 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18.8 dB (Minimum) / 19 dB (typisch); PAE: 37 % (typisch). Chipabmessungen: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 12700; Maximum: 14500; Wert: 12700–14500; Einheit: MHz

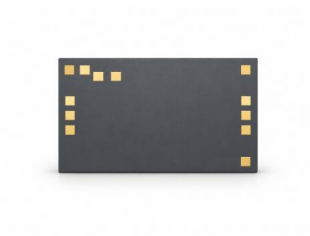
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46.8; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 18.8; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-15000-18000-PS38T

### 15000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 38 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); PAE: 40 % (typisch). Chipabmessungen: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 18000; Wert: 15000–18000; Einheit: MHz

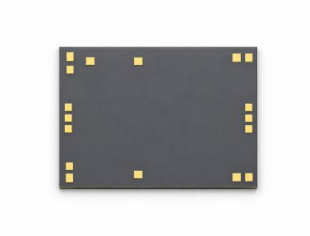
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 38; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13000-15000-PS42T

### 13000–15000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (Minimum) / 37 % (typisch). Chipabmessungen: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13000; Maximum: 15000; Wert: 13000–15000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.35; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

### 12000–15000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 47 dBm (Minimum) / 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (Minimum) / 22.5 dB (typisch); PAE: 30 % (Minimum) / 34 % (typisch). Chipabmessungen: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 12000; Maximum: 15000; Wert: 12000–15000; Einheit: MHz

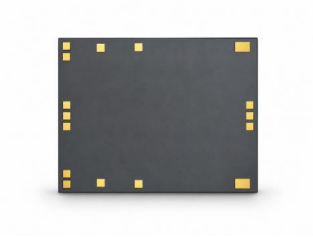
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

### 15000–17000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); PAE: 43 % (typisch). Chipabmessungen: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 17000; Wert: 15000–17000; Einheit: MHz

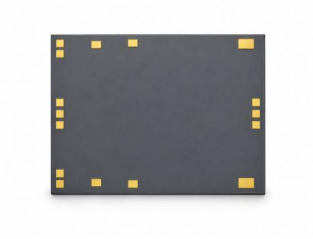
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-14000-18000-PS45T

### 14000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); PAE: 41 % (typisch). Chipabmessungen: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-15000-18500-PS48T

### 15000–18500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 15000; Maximum: 18500; Wert: 15000–18500; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13750-15350-PS48T

### 13750–15350 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 47 dBm (Minimum) / 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13750; Maximum: 15350; Wert: 13750–15350; Einheit: MHz

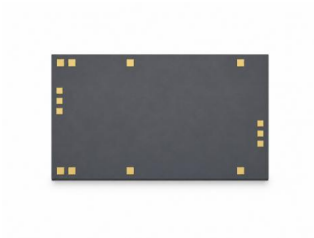
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-34000-64000-PS30T

### 34000–64000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 30 dBm (typisch); PAE: 17 % (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 34000; Maximum: 64000; Wert: 34000–64000; Einheit: MHz

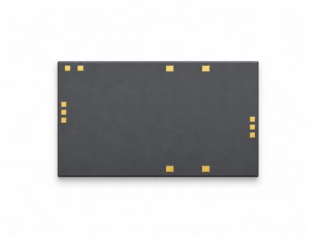
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 19; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 27; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 30; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

### 92000–96000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 34.5 dBm (typisch); PAE: 14 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 22 dB (typisch). Chipabmessungen: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 92000; Maximum: 96000; Wert: 92000–96000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: S21; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔS21; Typisch: ±1; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 34.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.7 dB (typisch) / 0.75 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 26.5 dB (Minimum) / 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 10; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Minimum: 26.5; Typisch: 28; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.7 dB (typisch) / 0.75 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 26.5 dB (Minimum) / 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 10; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Minimum: 26.5; Typisch: 28; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

### 14000–15000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 5 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 15000; Wert: 14000–15000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 32; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

### 14000–15000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 5 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 15000; Wert: 14000–15000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 32; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

### 800–4000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch) (Vd = +5 V); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 15 dBm (typisch) (Vd = +5 V). Chipabmessungen: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 800; Maximum: 4000; Wert: 800–4000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 15; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 32; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

### 800–4000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32 dB (typisch) (Vd = +5 V); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 15 dBm (typisch) (Vd = +5 V). Chipabmessungen: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 800; Maximum: 4000; Wert: 800–4000; Einheit: MHz

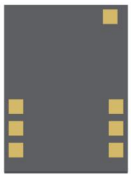
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 15; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 32; Wert: Vd = +5 V; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-30-600-NF0p6T

### 30–600 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 32.3 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 30; Maximum: 600; Wert: 30–600; Einheit: MHz

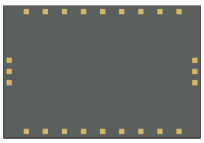
**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 32.3; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±0.3; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

### 75000–110000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 2.8 dB (typisch) (f = 90000 MHz); Rauschzahl: 3.3 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 25 dB (typisch) (f = 75000–90000 MHz); Kleinsignalverstärkung: 22 dB (typisch) (f = 90000–110000 MHz). Chipabmessungen: 2 × 3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 75000; Maximum: 110000; Wert: 75000–110000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 25; Einheit: dB; Hinweise: f = 75000–90000 MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 22; Einheit: dB; Hinweise: f = 90000–110000 MHz

**Eingangsrückflussdämpfung:** Typisch: 6; Einheit: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

### 17000–22000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die

Rauschzahl: 1.3 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 26 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 4 dBm (typisch). Chipabmessungen: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 17000; Maximum: 22000; Wert: 17000–22000; Einheit: MHz

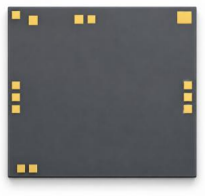
**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 26; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Typisch: ±0.5; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Typisch: 1.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3900-PS31T

### 2700–3900 MHz GaAs-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 30.5 dBm (Minimum) / 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 35.5 dB (Minimum) / 36 dB (typisch); PAE: 45 % (Minimum) / 48 % (typisch). Chipabmessungen in der Draufsicht: 2.5 × 2.262 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 30.5; Typisch: 31; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 35.5; Typisch: 36; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

### 2700–3900 MHz GaAs-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 34 dBm (Minimum) / 34.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 29 dB (Minimum) / 29.5 dB (typisch); PAE: 47 % (Minimum) / 49 % (typisch). Chipabmessungen in der Draufsicht: 2.2 × 3.092 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

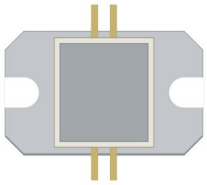
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 34; Typisch: 34.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 29; Typisch: 29.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-200-2200-PS41T

### 200–2200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker im Metall-Keramik-Gehäuse

Sättigungsausgangsleistung: 39.5 dBm (Minimum) / 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 23.5 dB (Minimum) / 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (Minimum) / 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 200; Maximum: 2200; Wert: 200–2200; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 39.5; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 23.5; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = +16 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T

### 8000–12000 MHz Rauscharmer Verstärker im QFN-Gehäuse

Rauschzahl: 0.9 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Gehäuseabmessungen: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 10; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 28; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Typisch: 0.9; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T-M

### 8000–12000 MHz Rauscharmer Verstärker im QFN-Gehäuse

Rauschzahl: 0.9 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung: 28 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 10 dBm (typisch). Gehäuseabmessungen: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

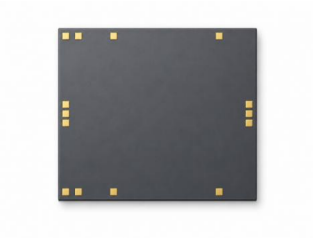
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 10; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 28; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Typisch: 0.9; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS42T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 20 % (typisch); Chipabmessungen: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41.2; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 16.2; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS29T

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 29 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 14 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 15 % (typisch); Chipabmessungen: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 13; Typisch: 14; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 29; Einheit: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

### 4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 20; Typisch: 20.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

### 2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 2.8 × 2.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

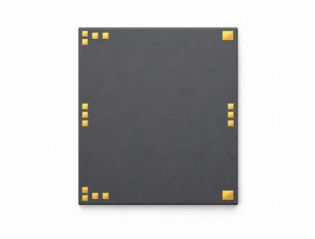
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 39.5; Typisch: 40.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21.5; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

### 2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 42 % (typisch); Chipabmessungen: 3.17 × 3.58 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

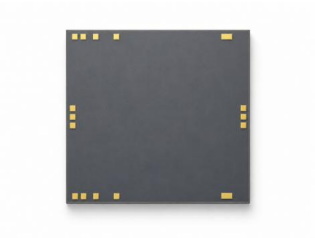
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44.8; Typisch: 45.8; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 17.8; Typisch: 18.8; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-10000-PS45T

### 4000–10000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–10000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 10000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 43.8; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 15.8; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

### 2500–6200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 6200; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 17.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

### 8500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 47 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

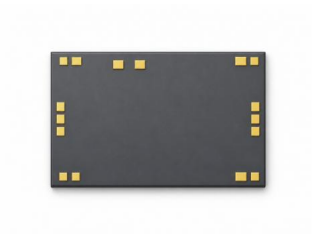
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.8; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 21.8; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 43 % (typisch); Chipabmessungen: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41.2; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21.2; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-18000-PS40T

### 2000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

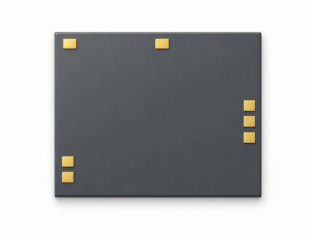
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 40; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 12; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 33.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 12 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 20 % (typisch); Chipabmessungen: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

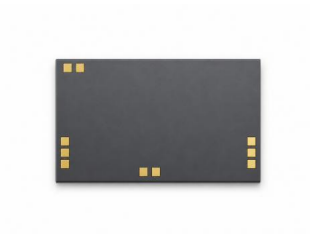
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 33; Typisch: 33.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 11; Typisch: 12; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-18000-PS35T

### 2000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 7 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

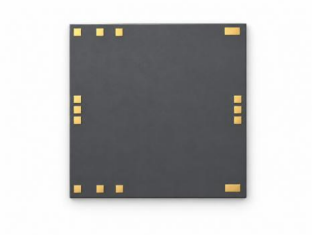
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 7; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

### 9200–10400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

9200–10400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.2 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.2 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9200; Maximum: 10400; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.2; Maximum: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.2; Maximum: 24.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-7500-10500-PS49T

### 7500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

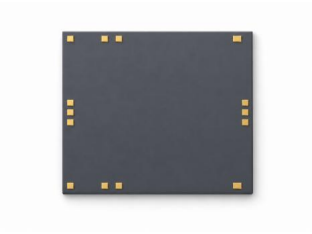
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 48.6; Typisch: 49; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24.6; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-7000-13000-PS45T

### 7000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS45T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 23 % (typisch); Chipabmessungen: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44.5; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19.5; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

### 5000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 49.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 26.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

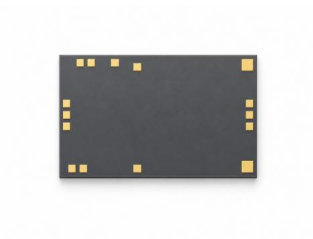
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 49; Typisch: 49.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 26; Typisch: 26.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS40T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 23 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

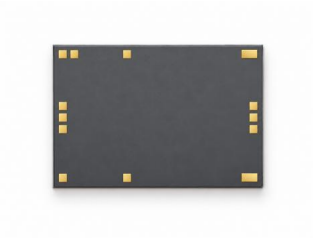
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 39; Typisch: 40; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 18; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10000-18000-PS41T

### 10000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

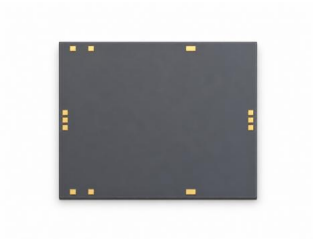
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 40.9; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 18.9; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-950-1250-PS47p5T

### 950–1250 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

950–1250 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 60 % (typisch); Chipabmessungen: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 950; Maximum: 1250; Einheit: MHz

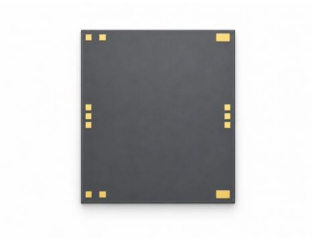
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

### 5000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 53 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

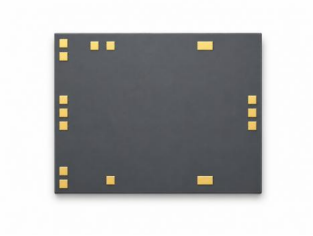
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 39 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 43 % (typisch); Chipabmessungen: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 38; Typisch: 39; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.7; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8500-10500-PS52T

### 8500–10500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8500–10500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 52 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 10500; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 52; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

### 4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17.5 dB (typisch); PAE 40% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

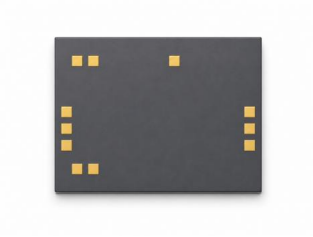
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 17; Typisch: 17.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS37T

### 4000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20 dB (typisch); PAE 35% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

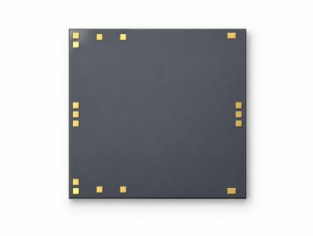
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 36.5; Typisch: 37; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19.5; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS47T

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

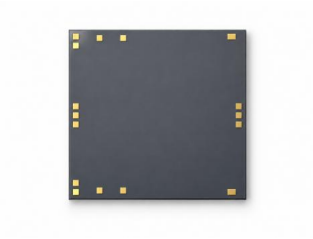
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46.5; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

### 8000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 45 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

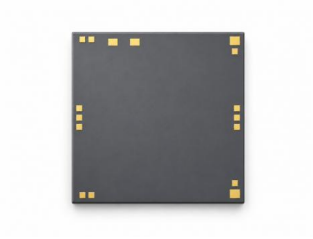
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46.5; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

### 3600–5000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 23.5 dB (typisch); PAE 43% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 3600; Maximum: 5000; Einheit: MHz

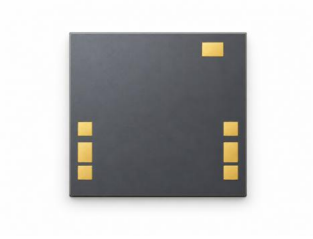
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 23; Typisch: 23.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-13000-PS25T

### 5000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 25 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 10 dB (typisch); Chipabmessungen: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

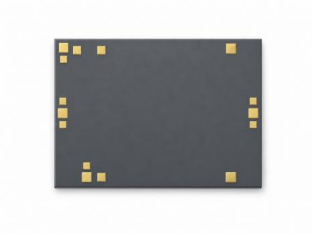
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 25; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 10; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-13000-PS42T

### 5000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 35 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4200-7000-PS42T

### 4200–7000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22 dB (typisch); PAE 45% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4200; Maximum: 7000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41.8; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 21.8; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

### 2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20.5 dB (typisch); PAE 35% (typisch); CW; Vd = +24 V.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

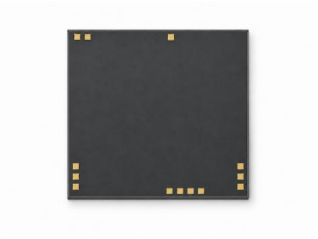
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 20; Typisch: 20.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-200-2200-PS41p5T

### 200–2200 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

GaN-on-SiC-Verstärkerchip für 200–2200 MHz mit typisch 41.5 dBm Sättigungsleistung, typisch 25.5 dB Leistungsverstärkung und Abmessungen von 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 200; Maximum: 2200; Einheit: MHz

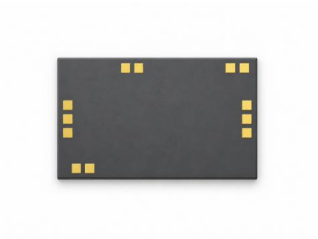
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41.0; Typisch: 41.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 25.0; Typisch: 25.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.0; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-3400-5600-PS40T

### 3400–5600 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17 dB (typisch); PAE 46% (typisch); CW.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 3400; Maximum: 5600; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 39; Typisch: 40; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 16; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5800-6800-PS47T

### 5800–6800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

5800–6800 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 46 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5800; Maximum: 6800; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

### 2700–3500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 25.5 dB (typisch); PAE 58% (typisch); CW.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Einheit: MHz

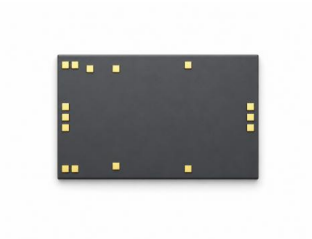
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 25; Typisch: 25.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6700-7400-PS41T

### 6700–7400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6700–7400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 55 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6700; Maximum: 7400; Einheit: MHz

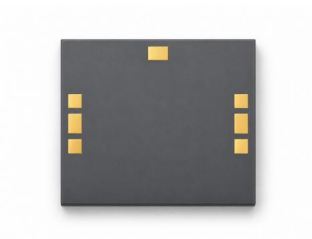
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS27T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 27 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 9 dB (typisch); Chipabmessungen: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

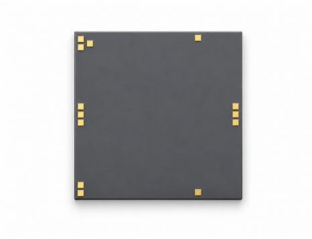
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 26; Typisch: 27; Maximum: 29; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 8; Typisch: 9; Maximum: 11; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-8000-PS42T

### 2000–8000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 15 dB (typisch); PAE 30% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 8000; Einheit: MHz

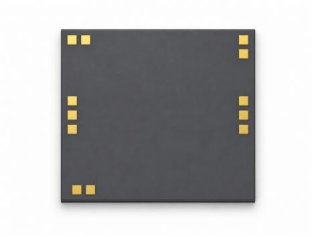
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41; Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 14; Typisch: 15; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

### 2500–3700 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22.5 dB (typisch); PAE 50% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 3700; Einheit: MHz

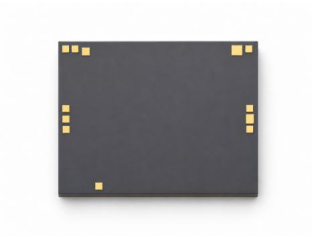
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 41; Typisch: 41.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 22; Typisch: 22.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

### 2600–3300 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 25.5 dB (typisch); PAE 60% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2600; Maximum: 3300; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 25; Typisch: 25.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

### 2400–3800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 27.5 dB (typisch); PAE 56% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2400; Maximum: 3800; Einheit: MHz

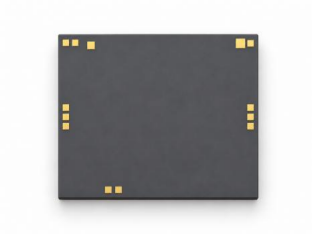
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 27; Typisch: 27.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-4000-PS47T

### 2500–4000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26 dB (typisch); PAE 52% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 4000; Einheit: MHz

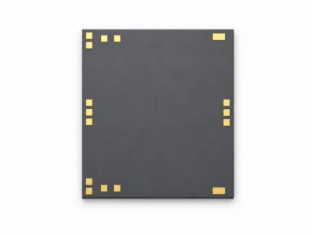
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46.2; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 25.2; Typisch: 26; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-9400-PS45T

### 8000–9400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–9400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 31 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 9400; Einheit: MHz

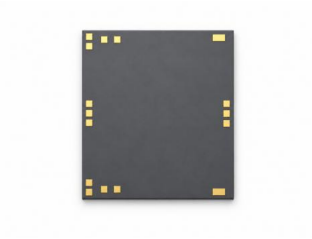
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 31; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

### 8000–9400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–9400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 31 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3 × 3.2 × 0.1 mm. RF-Prüfbedingungen: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 9400; Einheit: MHz

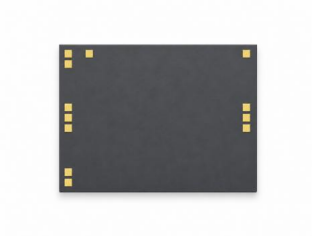
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 31; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

### 1200–1600 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1200–1600 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 17 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 60 % (typisch); Chipabmessungen: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 1600; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

### 8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 28 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

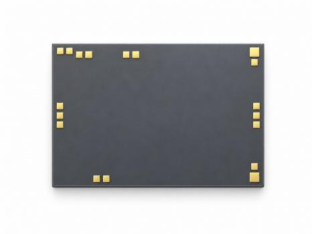
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Maximum: 47.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4400-6500-PS44T

### 4400–6500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

4400–6500 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 27 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 47 % (typisch); Chipabmessungen: 3.51 × 2.44 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4400; Maximum: 6500; Einheit: MHz

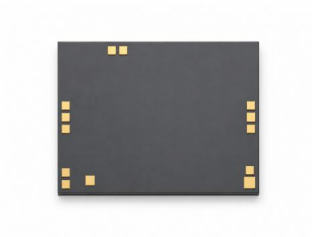
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 43.5; Typisch: 44; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 26.5; Typisch: 27; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

### 2700–3500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 61% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Einheit: MHz

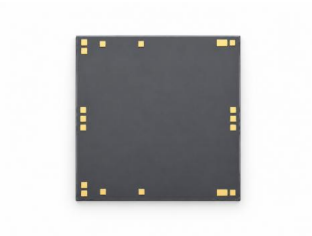
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 43; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 26; Typisch: 26.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10800-13000-PS45T

### 10800–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10800–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10800; Maximum: 13000; Einheit: MHz

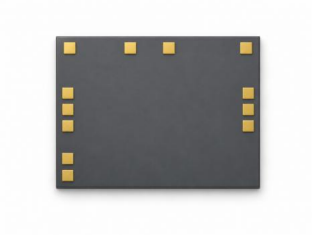
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-9000-11000-PS37T

### 9000–11000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

9000–11000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 37 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 22 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 38 % (typisch); Chipabmessungen: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 11000; Einheit: MHz

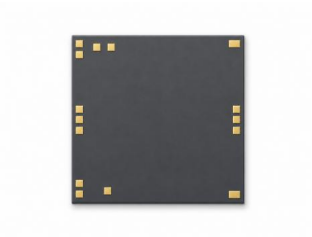
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 37; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-8400-PS45T

### 8000–8400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–8400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 23 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 55 % (typisch); Chipabmessungen: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 8400; Einheit: MHz

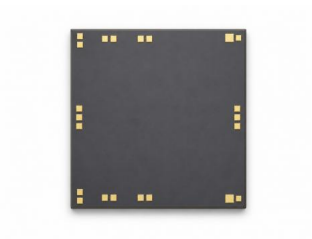
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 23; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

### 3700–5000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 27 dB (typisch); PAE 48% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 3700; Maximum: 5000; Einheit: MHz

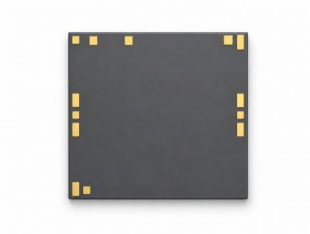
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 45; Typisch: 45.2; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 26.8; Typisch: 27; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

### 2000–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 26.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 50 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 2.9 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Einheit: MHz

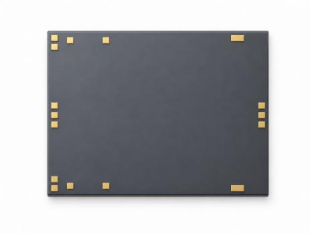
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 42.5; Typisch: 43; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 25.5; Typisch: 26.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-18000-PS44T

### 6000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 44; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-18000-PS44T

### 8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 44 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

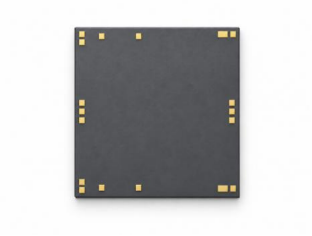
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 44; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 19; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10000-13000-PS45T

### 10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

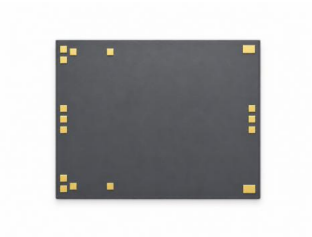
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

### 8000–18000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

8000–18000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 43.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 30 % (typisch); Chipabmessungen: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Einheit: MHz

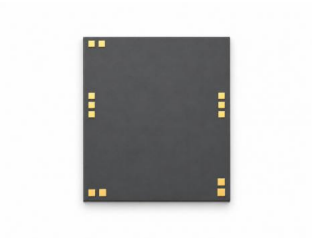
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 43.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 19.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-2800-PS41T

### 2000–2800 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–2800 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 56 % (typisch); Chipabmessungen: 2.4 × 2.7 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 2800; Einheit: MHz

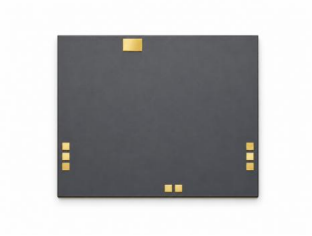
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 40.7; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 23.7; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: 1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-300-6000-PS40p8T

### 300–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

300–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 40.8 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 12.8 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 40; Typisch: 40.8; Maximum: 41.6; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 12; Typisch: 12.8; Maximum: 13.6; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.8; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-18500-PS43T

### 2000–18500 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13 dB (typisch); PAE 20% (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18500; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 43; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 13; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

### 1950–4050 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1950–4050 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24.5 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 52 % (typisch); Chipabmessungen: 3.56 × 3.78 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1950; Maximum: 4050; Einheit: MHz

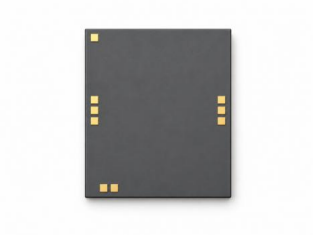
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24; Typisch: 24.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-300-6000-PS30T

### 300–6000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

300–6000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 30 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 15 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 15 % (typisch); Chipabmessungen: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 28; Typisch: 30; Maximum: 32.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 13; Typisch: 15; Maximum: 17.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±2.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3900-PS48T

### 2700–3900 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 56% (typisch); τ = 100 µs; D = 10%.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Einheit: MHz

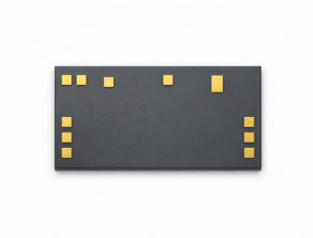
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47.6; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 23.6; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.6; Einheit: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

### 10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 30.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 30 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 22 % (typisch); Chipabmessungen: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 30; Typisch: 30.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 30; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10000-13000-PS48T

### 10000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

10000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 20 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 37 % (typisch); Chipabmessungen: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

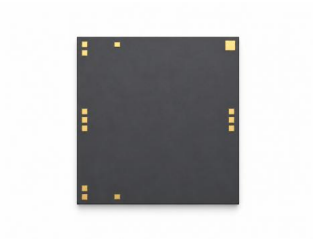
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 47; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 19; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-1200-2400-PS45T

### 1200–2400 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

1200–2400 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 53 % (typisch); Chipabmessungen: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 2400; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 44.5; Typisch: 45; Maximum: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 24.5; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-12000-PS48T

### 6000–12000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

6000–12000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 12000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-7000-13000-PS48T

### 7000–13000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

7000–13000 MHz; Sättigungsausgangsleistung: 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 24 dB (typisch); Leistungsaddierte Effizienz: 40 % (typisch); Chipabmessungen: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Einheit: MHz

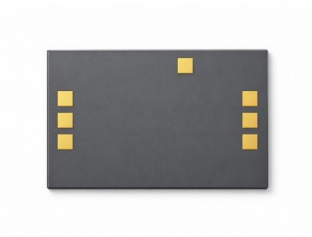
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

### 5000–6000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB (typisch)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); P1dB 6 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

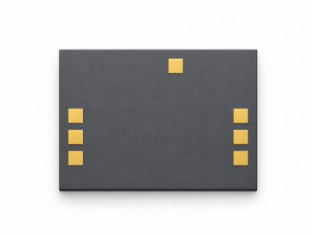
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 6; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

### 7000–13000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.9 dB (typisch)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

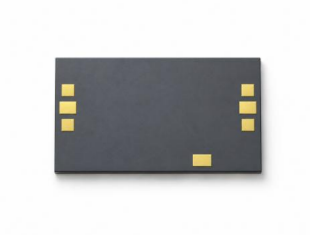
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Maximum: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-7000-13000-NF1T

### 7000–13000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1 dB (typisch)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

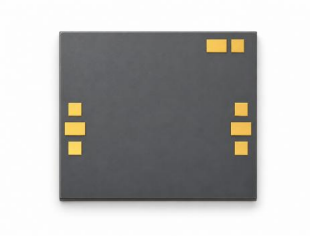
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 6; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Minimum: 28; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

### 2000–6000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.8 dB (typisch)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

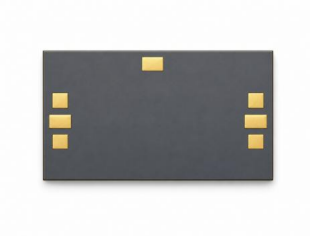
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 10; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Minimum: 29; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

### 6000–18000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.2 dB (typisch)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch); P1dB 8 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

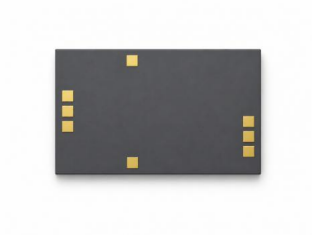
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 8; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 22; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

**24000–40000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 2.5 dB (typisch)**

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); P1dB ≥ 11 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 24000; Maximum: 40000; Wert: 24000–40000; Einheit: MHz

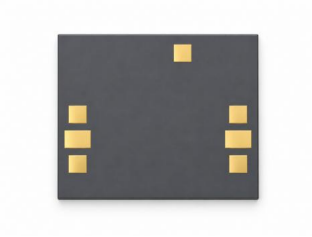
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Minimum: 11; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

**8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.7 dB (typisch)**

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB 8 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Minimum: 7; Typisch: 8; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Minimum: 25; Typisch: 26; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Maximum: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-20000-NF2T

**2000–20000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 2 dB (typisch)**

2000–20000 MHz; NF 2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 17 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 20000; Wert: 2000–20000; Einheit: MHz

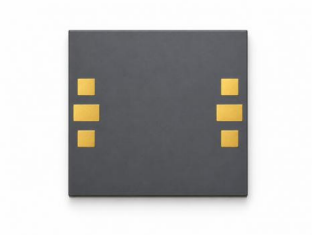
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

**100–2000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.1 dB (typisch)**

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 17.5 dB (typisch); P1dB 19.5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 2000; Wert: 100–2000; Einheit: MHz

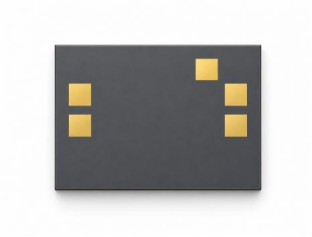
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 19.5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 17.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

**800–2000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch)**

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); P1dB 20.5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

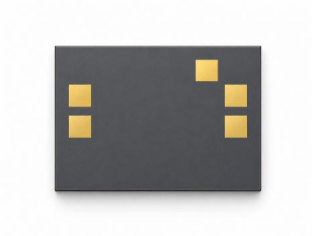
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 20.5; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 22; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-200-600-NF0p4T

**200–600 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.4 dB (typisch)**

200–600 MHz; NF 0.4 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); P1dB 21 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 200; Maximum: 600; Wert: 200–600; Einheit: MHz

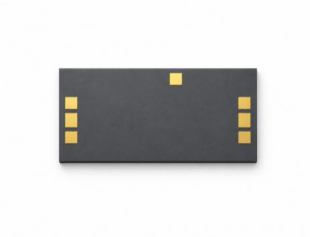
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 21; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 22.5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

**2000–5000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch)**

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 30 dB (typisch); P1dB 14 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 14; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 15; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 30; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

**7000–9000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB**

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Kleinsignalverstärkung 31 dB (typisch); P1dB 15 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 9000; Wert: 7000–9000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 15; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 31; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

**6000–20000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.2 dB (typisch)**

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB -2 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 20000; Wert: 6000–20000; Einheit: MHz

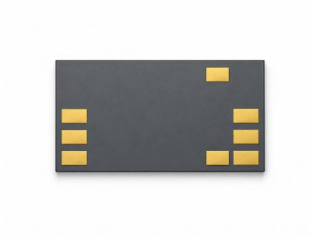
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Minimum: -4; Typisch: -2; Maximum: 0; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

### 4000–12000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.6 dB (typisch)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 34.5 dB (typisch); P1dB 7 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 12000; Wert: 4000–12000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Minimum: 6.5; Typisch: 7; Maximum: 8.5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 34.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

### 2000–5000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 0.45 dB (typisch); P1dB 11 dBm (typisch)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 30 dB (typisch); P1dB 11 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 11; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 12; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 30; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

### 32000–52000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.8 dB (typisch)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB 5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 32000; Maximum: 52000; Wert: 32000–52000; Einheit: MHz

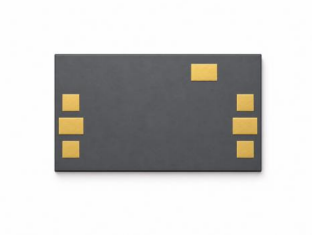
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 16 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 24 dB (typisch); NF 1.7 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

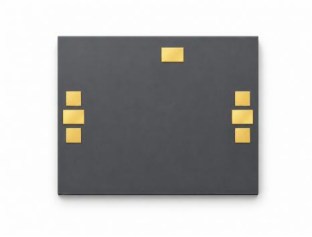
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 16; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 24; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

### 700–5000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 19 dBm (typisch)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 14 dB (typisch); NF 2.5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 700; Maximum: 5000; Wert: 700–5000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 19; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 14; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

### 2700–3500 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 28 dB (typisch); NF 3.5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

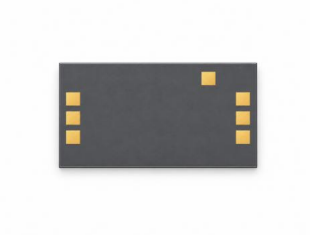
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 23.5; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 25; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 28; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

### 14000–18000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23 dBm (typisch)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 19 dB (typisch); NF 5.5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

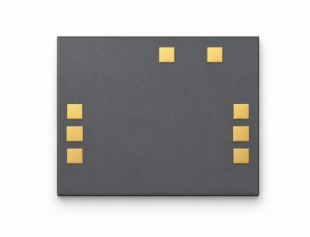
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 23; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 24; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 19; Maximum: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

### 5000–20000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 20 dBm (typisch)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 6.5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 20000; Wert: 5000–20000; Einheit: MHz

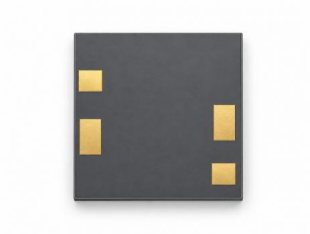
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 20; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 21; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

### DC–6000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 22.8 dBm (typisch)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 1.8 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

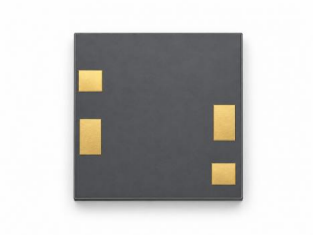
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 22.8; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

### DC–6000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 21 dBm (typisch)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 20 dB (typisch); NF 1 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

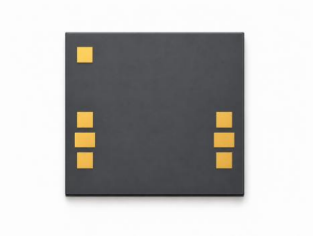
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 21; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±1; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

### 800–2000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 15 dBm (typisch)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 17 dB (typisch); NF 1.4 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

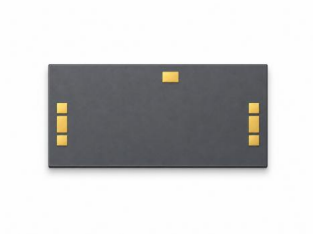
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 15; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 17; Einheit: dB

**Welligkeit der Kleinsignalverstärkung:** Symbol: ΔGain; Typisch: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

### 2000–7000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23.5 dBm (typisch)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 7000; Wert: 2000–7000; Einheit: MHz

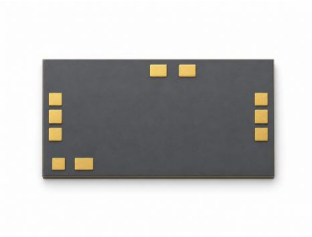
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 23.5; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 24.5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-8000-12000-PS28T

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — PSAT 28 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

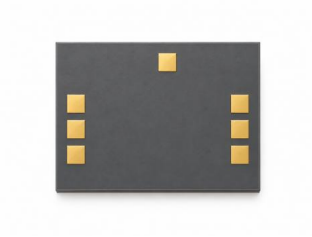
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 27.8; Typisch: 28; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 19; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

### 4000–9000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 17 dBm (typisch)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 13 dB (typisch); NF 3.5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 9000; Wert: 4000–9000; Einheit: MHz

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 17; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 18; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 13; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

### 2000–18000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 16 dBm (typisch)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch); NF 3 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

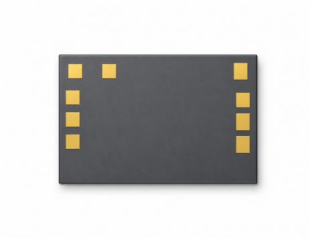
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 16; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 17; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

### 6000–12000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — P1dB 23 dBm (typisch)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); NF 5 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 12000; Wert: 6000–12000; Einheit: MHz

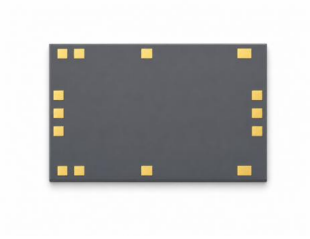
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P1dB; Typisch: 23; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Wert: 23.8; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 23; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-24000-31000-PS25T

### 24000–31000 MHz GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — PSAT 25 dBm (typisch)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 22 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 24000; Maximum: 31000; Wert: 24000–31000; Einheit: MHz

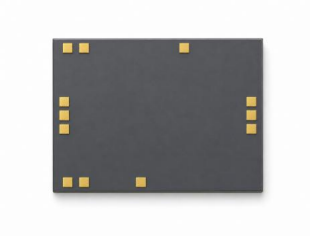
**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 22; Einheit: dB

**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 25; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 20; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

### 8000–18000 MHz Bidirektionaler GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — Rx / Tx P1dB 24 dBm (typisch)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 21 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Wert: 8000–18000; Einheit: MHz

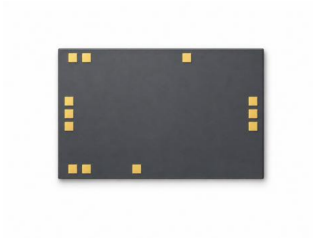
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx):** Typisch: 24; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung (Rx):** Typisch: 24.5; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Typisch: 21; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

### 6000–18000 MHz Bidirektionaler GaAs-MMIC-Verstärker als Bare Die — Rx / Tx P1dB 21 dBm (typisch)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (typisch); Kleinsignalverstärkung 19 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

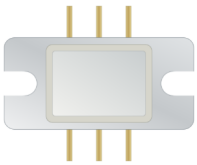
**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx):** Typisch: 21; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung (Rx):** Typisch: 22; Einheit: dBm

**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Typisch: 19; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS40T

### 2000–6000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 40 dBm (typisch)

2000–6000 MHz; PSAT 40 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22 dB (typisch); PAE 38 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

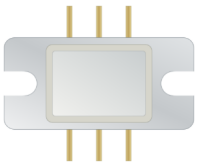
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 39.5; Typisch: 40; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 21.5; Typisch: 22; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 32; Typisch: 38; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-7500-10500-PS48T

### 7500–10500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 48 dBm (typisch)

7500–10500 MHz; PSAT 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7500; Maximum: 10500; Wert: 7500–10500; Einheit: MHz

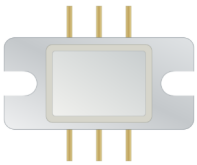
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 47.5; Typisch: 48; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 23.5; Typisch: 24; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 32; Typisch: 40; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-8500-PS41T

### 2000–8500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 41 dBm (typisch)

2000–8500 MHz; PSAT 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 15 dB (typisch); PAE 35 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 8500; Wert: 2000–8500; Einheit: MHz

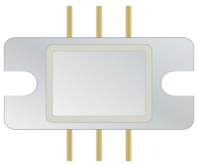
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 40.3; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 14.3; Typisch: 15; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 25; Typisch: 35; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-6200-PS44p5T

### 2500–6200 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 44.5 dBm (typisch)

2500–6200 MHz; PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 16.5 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 6200; Wert: 2500–6200; Einheit: MHz

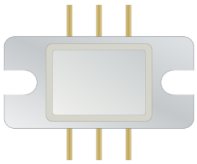
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 16; Typisch: 16.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 35; Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-6000-PS47T

### 5000–6000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 47 dBm (typisch)

5000–6000 MHz; PSAT 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 56 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

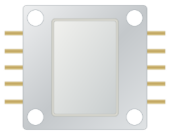
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 46.2; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 23.2; Typisch: 24; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 50; Typisch: 56; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13400-14600-PS44p5T

### 13400–14600 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 44.5 dBm (typisch)

13400–14600 MHz; PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19.5 dB (typisch); PAE 32 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13400; Maximum: 14600; Wert: 13400–14600; Einheit: MHz

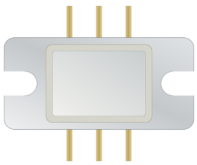
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 43.7; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 19.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 28; Typisch: 32; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5000-6000-PS49T

### 5000–6000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 49 dBm (typisch)

5000–6000 MHz; PSAT 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26 dB (typisch); PAE 53 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

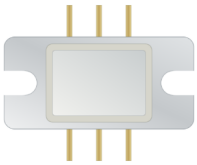
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 48.5; Typisch: 49; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 25.5; Typisch: 26; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 51; Typisch: 53; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-3700-PS41T

### 2500–3700 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 41 dBm (typisch)

2500–3700 MHz; PSAT 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22 dB (typisch); PAE 47 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 3700; Wert: 2500–3700; Einheit: MHz

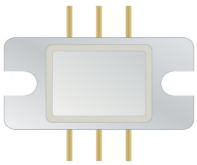
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 40.5; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 21.5; Typisch: 22; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 42; Typisch: 47; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-13600-14500-PS41MIN

**13600–14500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 41 dBm**

13600–14500 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 20 dB; PAE 37 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 13600; Maximum: 14500; Wert: 13600–14500; Einheit: MHz

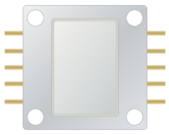
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 20; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 32; Typisch: 37; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-6000-12000-PS46T

**6000–12000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46 dBm (typisch)**

6000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 22 dB (typisch); PAE 30 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 12000; Wert: 6000–12000; Einheit: MHz

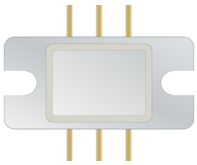
**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 46; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 22; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 30; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4200-7000-PS41MIN

**4200–7000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 41 dBm**

4200–7000 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 21 dB; PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4200; Maximum: 7000; Wert: 4200–7000; Einheit: MHz

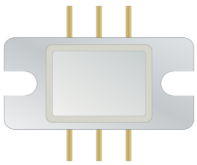
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 21; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 40; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-5000-PS45MIN

**4000–5000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 45 dBm**

4000–5000 MHz; PSAT ≥ 45 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 26 dB; PAE 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 5000; Wert: 4000–5000; Einheit: MHz

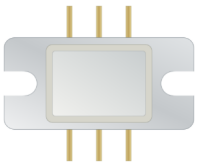
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 26; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 40; Typisch: 50; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-1200-1600-PS42MIN

**1200–1600 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 42 dBm**

1200–1600 MHz; PSAT ≥ 42 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 16 dB; PAE 55 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 1600; Wert: 1200–1600; Einheit: MHz

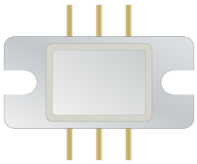
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 16; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 45; Typisch: 55; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2500-4000-PS46p5T

**2500–4000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46.5 dBm (typisch)**

2500–4000 MHz; PSAT 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2500; Maximum: 4000; Wert: 2500–4000; Einheit: MHz

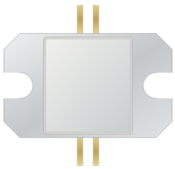
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 46; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 25; Typisch: 26.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C

### 2700–3500 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 45.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26.5 dB (typisch); PAE 55 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

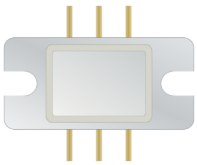
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 44.5; Typisch: 45.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 25.5; Typisch: 26.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 50; Typisch: 55; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS43T

### 4000–8000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 43 dBm (typisch)

4000–8000 MHz; PSAT 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 20 dB (typisch); PAE 35 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Wert: 4000–8000; Einheit: MHz

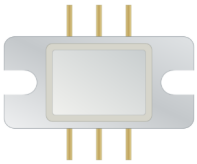
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 42; Typisch: 43; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 19; Typisch: 20; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 30; Typisch: 35; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 23 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-3400-4800-PS43T

### 3400–4800 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 43 dBm (typisch)

3400–4800 MHz; PSAT 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 23 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 3400; Maximum: 4800; Wert: 3400–4800; Einheit: MHz

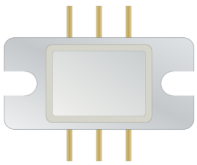
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 42; Typisch: 43; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 22; Typisch: 23; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 35; Typisch: 45; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-9200-10400-PS45T

### 9200–10400 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 45 dBm (typisch)

9200–10400 MHz; PSAT 45 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 23 dB (typisch); PAE 38 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9200; Maximum: 10400; Wert: 9200–10400; Einheit: MHz

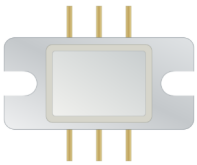
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 44.7; Typisch: 45; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 22.7; Typisch: 23; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 35; Typisch: 38; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-8000-PS42p5T

### 2000–8000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 42.5 dBm (typisch)

2000–8000 MHz; PSAT 42.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 15.5 dB (typisch); PAE 28 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 8000; Wert: 2000–8000; Einheit: MHz

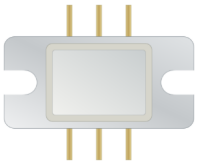
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 40; Typisch: 42.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 13; Typisch: 15.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 25; Typisch: 28; Einheit: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-5800-6800-PS46p5T

### 5800–6800 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46.5 dBm (typisch)

5800–6800 MHz; PSAT 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 21 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5800; Maximum: 6800; Wert: 5800–6800; Einheit: MHz

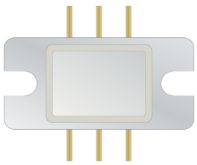
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 45.5; Typisch: 46.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 20; Typisch: 21; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 26 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS44p5T

### 2000–6000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 44.5 dBm (typisch)

2000–6000 MHz; PSAT 44.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 17.5 dB (typisch); PAE 35 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

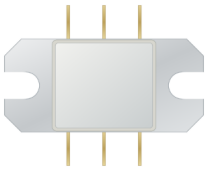
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 44; Typisch: 44.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 17; Typisch: 17.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 30; Typisch: 35; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 27 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS42T-C

### 8000–12000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 42 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; PSAT 42 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 21 dB (typisch); PAE 38 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

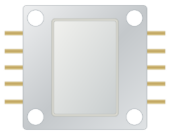
**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 42; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 21; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 38; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 21 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS46T

### 8000–12000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 46 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 24 dB (typisch); PAE 37 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

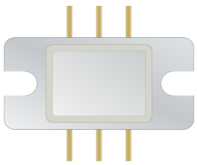
**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 46; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 24; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 37; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS36p5T

**4000–8000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 36.5 dBm (typisch)**

4000–8000 MHz; PSAT 36.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19.5 dB (typisch); PAE 35 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Wert: 4000–8000; Einheit: MHz

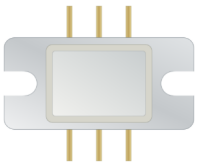
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 36; Typisch: 36.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 19; Typisch: 19.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 30; Typisch: 35; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-4000-8000-PS47T

**4000–8000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 47 dBm (typisch)**

4000–8000 MHz; PSAT 47 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 8000; Wert: 4000–8000; Einheit: MHz

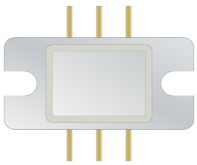
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 46.5; Typisch: 47; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 18.5; Typisch: 19; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 32; Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 28 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2000-6000-PS43T-C

**2000–6000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 43 dBm (typisch)**

2000–6000 MHz; PSAT 43 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 26 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

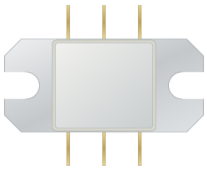
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 42.5; Typisch: 43; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 25.5; Typisch: 26; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 35; Typisch: 45; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-8000-12000-PS39T-C

### 8000–12000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 39 dBm (typisch)

8000–12000 MHz; PSAT 39 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 18 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

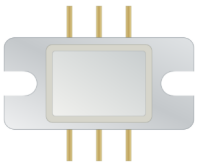
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 37; Typisch: 39; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 17; Typisch: 18; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-9000-11000-PS36MIN

### 9000–11000 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 36 dBm

9000–11000 MHz; PSAT ≥ 36 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 23 dB; PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 11000; Wert: 9000–11000; Einheit: MHz

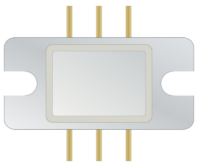
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 36; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 23; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 33; Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 13 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-2700-3500-PS31p5T

### 2700–3500 MHz GaAs Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT 31.5 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; PSAT 31.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 36.5 dB (typisch); PAE 40 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

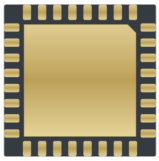
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 31; Typisch: 31.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 36; Typisch: 36.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 37; Typisch: 40; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PA-10-1100-PS40MIN

### 10–1100 MHz GaN Gehäuster Leistungsverstärker — PSAT ≥ 40 dBm

10–1100 MHz; PSAT ≥ 40 dBm; Leistungsverstärkung ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 10; Maximum: 1100; Wert: 10–1100; Einheit: MHz

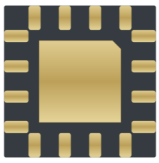
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 40; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 13; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 60; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-4000-12000-NF0p8T

### 4000–12000 MHz Gehäuster rauscharmer Verstärker — NF 0.8 dB (typisch)

4000–12000 MHz; Kleinsignalverstärkung 34 dB (typisch); Rauschzahl 0.8 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 7 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 4000; Maximum: 12000; Wert: 4000–12000; Einheit: MHz

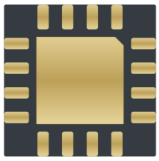
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 34; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 0.8; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 7; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB10p5T

### 2000–5000 MHz Gehäuster rauscharmer Verstärker — NF 0.65 dB (typisch)

2000–5000 MHz; Kleinsignalverstärkung 29 dB (typisch); Rauschzahl 0.65 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 10.5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

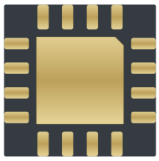
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 29; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 0.65; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 10.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB14T

### 2000–5000 MHz Gehäuster rauscharmer Verstärker — NF 0.65 dB (typisch)

2000–5000 MHz; Kleinsignalverstärkung 29 dB (typisch); Rauschzahl 0.65 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 14 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 5000; Wert: 2000–5000; Einheit: MHz

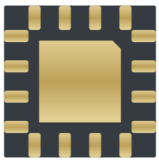
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 29; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 0.65; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 14; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG26T

### 8000–12000 MHz Gehäuster rauscharmer Verstärker — NF 0.9 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); Rauschzahl 0.9 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt ≥ 7 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

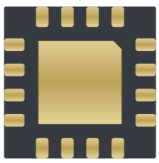
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 0.9; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Minimum: 7; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -30 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LNA-6000-20000-NF1p5T

### 6000–20000 MHz Gehäuster rauscharmer Verstärker — NF 1.5 dB (typisch)

6000–20000 MHz; Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); Rauschzahl 1.5 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt -2 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 20000; Wert: 6000–20000; Einheit: MHz

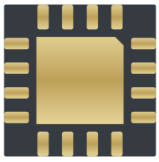
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 26; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 1.5; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: -2; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-2000-7000-P1DB23T

### 2000–7000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 23 dBm (typisch)

2000–7000 MHz; Kleinsignalverstärkung 20 dB (typisch); Rauschzahl 6 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 23 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 7000; Wert: 2000–7000; Einheit: MHz

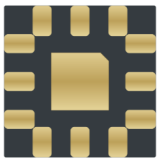
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 6; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 23; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-100-6000-P1DB20T

### 100–6000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 20 dBm (typisch)

100–6000 MHz; Kleinsignalverstärkung 17 dB (typisch); Rauschzahl 1.2 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 20 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 6000; Wert: 100–6000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 17; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 1.2; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 20; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-100-6000-P1DB22T

### 100–6000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 22 dBm (typisch)

100–6000 MHz; Kleinsignalverstärkung 20 dB (typisch); Rauschzahl 2 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 22 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 6000; Wert: 100–6000; Einheit: MHz

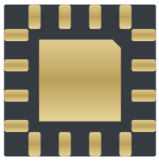
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 2; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 22; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-800-2000-P1DB14p5T

### 800–2000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 14.5 dBm (typisch)

800–2000 MHz; Kleinsignalverstärkung 16.5 dB (typisch); Rauschzahl 1.6 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 14.5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

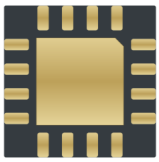
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 16.5; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 1.6; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 14.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-2700-3500-P1DB23T

### 2700–3500 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 23 dBm (typisch)

2700–3500 MHz; Kleinsignalverstärkung 27 dB (typisch); Rauschzahl 4 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 23 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

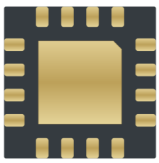
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 27; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 4; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 23; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-AMP-5000-20000-P1DB19p5T

### 5000–20000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 19.5 dBm (typisch)

5000–20000 MHz; Kleinsignalverstärkung 20 dB (typisch); Rauschzahl 6 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 19.5 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 20000; Wert: 5000–20000; Einheit: MHz

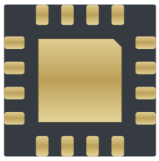
**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB

**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 6; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 19.5; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-C

**14000–18000 MHz Gehäuster RF-Verstärker — P1dB 23 dBm (typisch)**

14000–18000 MHz; Kleinsignalverstärkung 18 dB (typisch); Rauschzahl 6 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt 23 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Symbol: Gain; Typisch: 18; Einheit: dB

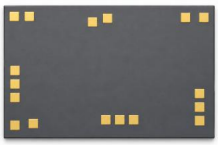
**Rauschzahl:** Symbol: NF; Typisch: 6; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Symbol: P_1; Typisch: 23; Einheit: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt

## HF-Frontend-ICs



### LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

**5000–13000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die**

PSAT: 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); PAE: 30 % (typisch). Chipabmessungen: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

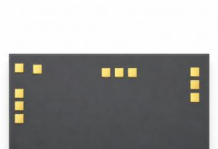
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 31; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

**5000–13000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die**

PSAT: 31 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 18 dB (typisch); PAE: 30 % (typisch). Chipabmessungen: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

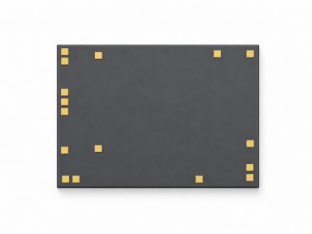
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 31; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 18; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±1.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

### 8000–12000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

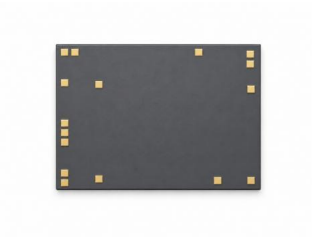
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

### 8000–12000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 41 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 25 dB (typisch); PAE: 38 % (typisch). Chipabmessungen: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

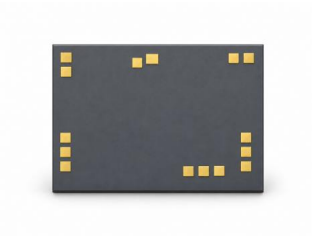
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 41; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 25; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

### 9000–10000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 10000; Wert: 9000–10000; Einheit: MHz

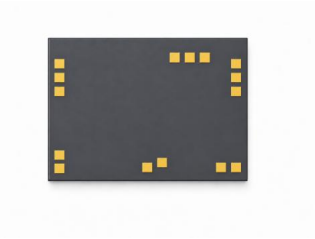
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

### 9000–10000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 35 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 21 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 9000; Maximum: 10000; Wert: 9000–10000; Einheit: MHz

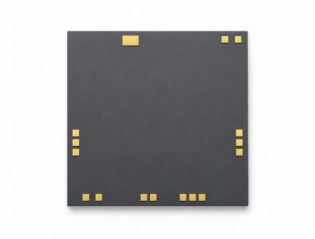
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 35; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Typisch: 21; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Maximum: ±0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TRPA-300-6000-PS39T

### 300–6000 MHz GaN-T/R MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

Pulsbetrieb: PSAT: 38.7 dBm (Minimum) / 39 dBm (typisch) / 40.5 dBm (Maximum); Leistungsverstärkung: 10.7 dB (Minimum) / 11 dB (typisch) / 12.5 dB (Maximum); PAE: 30 % (Minimum) / 35 % (typisch) / 53 % (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 300; Maximum: 6000; Wert: 300–6000; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Minimum: 38.7; Typisch: 39; Maximum: 40.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Symbol: Gp; Minimum: 10.7; Typisch: 11; Maximum: 12.5; Einheit: dB

**Welligkeit der Leistungsverstärkung:** Symbol: ΔGp; Typisch: ±0.9; Einheit: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pulsbetrieb

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 °; Dämpfungsbereich: 0–31.5 dB; Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt: 11 dBm (Minimum) / 13 dBm (typisch). Chipabmessungen: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

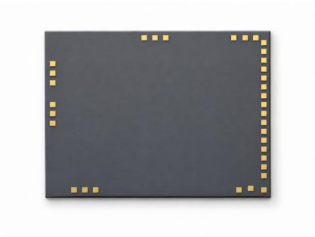
**Kleinsignalverstärkung:** Minimum: 7.5; Maximum: 10; Wert: TX / RX; Einheit: dB

**Isolation:** Minimum: 35; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Wert: 0–31.5; Einheit: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-APC-7000-13000

### 7000–13000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die

Phasenschritt: 5.625 ° (typisch); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum); Kleinsignalverstärkung: 12 dB (typisch) (RX). Chipabmessungen: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung:** Typisch: 12; Wert: RX; Einheit: dB

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt:** Typisch: 11; Wert: RX; Einheit: dBm

**Sättigungsausgangsleistung:** Typisch: 24; Wert: TX; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-APC-5000-6000

### 5000–6000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die — Rx 13 dB / Tx 27 dB (typisch)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (typisch); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Typisch: 13; Einheit: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

### 8000–12000 MHz GaAs-MMIC-RF-Frontend mit Amplituden- und Phasensteuerung als Bare Die — Rx 10 dB / Tx 26 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (typisch); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

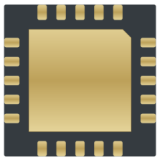
**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Typisch: 10; Einheit: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB23T

### 8000–18000 MHz Bidirektionales RF-Frontend-IC — RX / TX P1dB 23 dBm (typisch)

8000–18000 MHz; Kleinsignalverstärkung (Rx) 20 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung (Tx) 20 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx) 23 dBm (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Tx) 23 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 18000; Wert: 8000–18000; Einheit: MHz

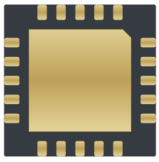
**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB; Hinweise: RX

**Kleinsignalverstärkung (Tx):** Symbol: Gain; Typisch: 20; Einheit: dB; Hinweise: TX

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx):** Symbol: P_1; Typisch: 23; Einheit: dBm; Hinweise: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB20T

### 6000–18000 MHz Bidirektionales RF-Frontend-IC — RX / TX P1dB 20 dBm (typisch)

6000–18000 MHz; Kleinsignalverstärkung (Rx) 18 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung (Tx) 18 dB (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx) 20 dBm (typisch); Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Tx) 20 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

**Kleinsignalverstärkung (Rx):** Symbol: Gain; Typisch: 18; Einheit: dB; Hinweise: RX

**Kleinsignalverstärkung (Tx):** Symbol: Gain; Typisch: 18; Einheit: dB; Hinweise: TX

**Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt (Rx):** Symbol: P_1; Typisch: 20; Einheit: dBm; Hinweise: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt

# Bare-Die- und Chip-Scale-HF-Bauelemente



## LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

### 12000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch) / 0.7 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 16.5 dBm (typisch) / 17.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 43 dBm (Maximum) (τ = 1 ms; D = 20%). Chipabmessungen: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

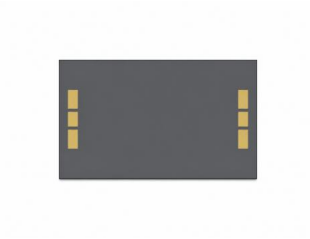
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.6; Maximum: 0.7; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.4

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-5000-6000

### 5000–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.45 dB (typisch) / 0.5 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 18.5 dBm (typisch) / 19.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 49 dBm (Maximum) (τ = 2 ms; D = 20%); Maximale gepulste Eingangsleistung: 50 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.45; Maximum: 0.5; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

### 8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.5 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 42 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

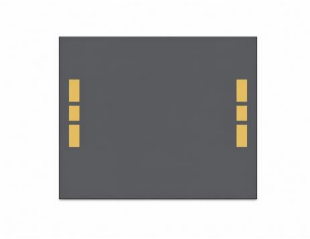
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.5; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

### 2000–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch) / 0.4 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 43 dBm (Maximum) (τ = 200 µs; D = 20%). Chipabmessungen: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

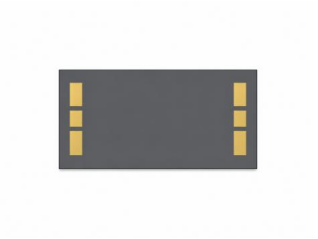
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.3; Maximum: 0.4; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.4

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

### 6000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16.5 dBm (typisch) / 17.5 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 42 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

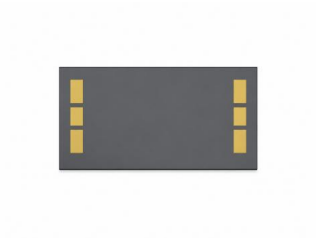
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.8; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.6

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.6

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

### 6000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 41 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.6; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.5

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

### 8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 48 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%); Maximale Eingangsleistung: 46 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.8; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.5

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

### DC–14000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch) / 0.5 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 14000; Wert: DC–14000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.4; Maximum: 0.5; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

### 8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.6 dB (typisch) / 0.7 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.6; Maximum: 0.7; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.6

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.6

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

### 8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.3; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

### 8000–12000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.3 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 37 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.3; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2; Maximum: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

### 10000–18000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.8 dB (typisch); Begrenzungspegel: 17 dBm (typisch) / 18 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 200 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 10000; Maximum: 18000; Wert: 10000–18000; Einheit: MHz

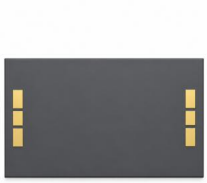
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.8; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.6; Maximum: 1.8

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.6; Maximum: 1.8

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

### DC–6000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.35 dB (typisch) / 0.4 dB (Maximum); Begrenzungspegel: 15 dBm (typisch) / 16 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 45 dBm (Maximum) (τ = 300 µs; D = 30%). Chipabmessungen: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 6000; Wert: DC–6000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.35; Maximum: 0.4; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.4; Maximum: 1.5

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.4; Maximum: 1.5

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

### 2000–4000 MHz GaAs-PIN-RF-Begrenzer als Bare Die

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Begrenzungspegel: 16 dBm (typisch) / 17 dBm (Maximum); Maximale gepulste Eingangsleistung: 51 dBm (Maximum) (τ = 100 µs; D = 10%); Maximale Eingangsleistung: 48 dBm (Maximum) (CW). Chipabmessungen: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 4000; Wert: 2000–4000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.4; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCRES-R15OHM

### 15 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 15 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.35 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.8 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

**Anzahl der Widerstände:** Wert: 1

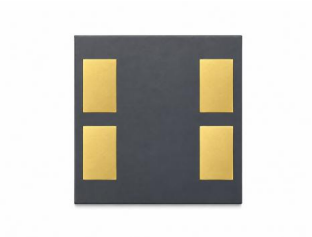
**Anzahl der Anschlüsse:** Wert: 2

**Widerstand:** Typisch: 15; Einheit: Ω

**Widerstandstoleranz:** Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCRES-N2-R20OHM

### 2 × 20 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 20 / 20 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.165 / 0.165 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.33 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

**Anzahl der Widerstände:** Wert: 2

**Anzahl der Anschlüsse:** Wert: 4

**Widerstand:** Typisch: 20 / 20; Einheit: Ω

**Widerstandstoleranz:** Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCRES-R50OHM

### 50 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 50 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.2 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.6 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

**Anzahl der Widerstände:** Wert: 1

**Anzahl der Anschlüsse:** Wert: 2

**Widerstand:** Typisch: 50; Einheit: Ω

**Widerstandstoleranz:** Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCRES-R1000OHM

### 1000 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 1000 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.04 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.08 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

**Anzahl der Widerstände:** Wert: 1

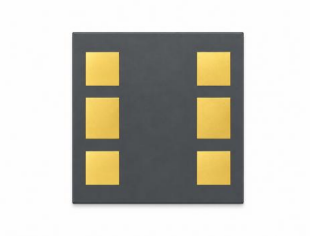
**Anzahl der Anschlüsse:** Wert: 2

**Widerstand:** Typisch: 1000; Einheit: Ω

**Widerstandstoleranz:** Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCCAP-C10PF

### 10 pF GaAs-Kondensatorchip

Kapazität: 10 pF (typisch); Spannungsfestigkeit: 50 V (typisch). Chipabmessungen: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

**Kapazität:** Typisch: 10; Einheit: pF; TA = +25 °C

**Spannungsfestigkeit:** Typisch: 50; Einheit: V; TA = +25 °C

**Durchbruchspannung:** Wert: 80 (Vb); Einheit: V

**Lagertemperatur:** Minimum: -65; Maximum: 150; Einheit: °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCEQ-8000-12000-D

### 8000–12000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 2 dB; Einfügedämpfung @ 8000 MHz: 2.6 dB; Einfügedämpfung @ 12000 MHz: 0.7 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

**Entzerrungsbetrag:** Wert: 2; Einheit: dB

**Einfügedämpfung @ 8000 MHz:** Wert: 2.6; Einheit: dB

**Einfügedämpfung @ 12000 MHz:** Wert: 0.7; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCEQ-2000-6000-D

### 2000–6000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 5.5 dB; Einfügedämpfung @ 2000 MHz: 0.6 dB; Einfügedämpfung @ 6000 MHz: 6.1 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

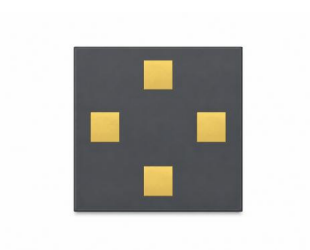
**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

**Entzerrungsbetrag:** Wert: 5.5; Einheit: dB

**Einfügedämpfung @ 2000 MHz:** Wert: 0.6; Einheit: dB

**Einfügedämpfung @ 6000 MHz:** Wert: 6.1; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCXOV-DC-40000-D

### DC–40000 MHz GaAs-RF-Kreuzungsbrückenchip

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Isolation: 30 dB (typisch); Rückflussdämpfung: 20 dB (typisch). Chipabmessungen: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 40000; Wert: DC–40000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.4; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 30; Einheit: dB

**Rückflussdämpfung:** Typisch: 20; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCBPF-17000-19000

**17000–19000 MHz GaAs Bandpassfilter als Bare Die — IL 2.7 dB (typisch)**

17000–19000 MHz; Einfügedämpfung 2.7 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 17000; Maximum: 19000; Wert: 17000–19000; Einheit: MHz

**Mittenfrequenz:** Typisch: 18000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 2.7; Einheit: dB

**Welligkeit im Durchlassband:** Typisch: 0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

## HF-Schalter-ICs



### LCI-SW-1000-12000-SPDT

**1000–12000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die**

Einfügedämpfung: 1 dB (typisch); Isolation: 34 dB (Minimum) / 63 dB (Maximum); Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression: 43 dBm (typisch). Chipabmessungen: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 1000; Maximum: 12000; Wert: 1000–12000; Einheit: MHz

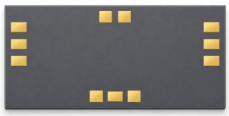
**Einfügedämpfung:** Typisch: 1; Einheit: dB

**Isolation:** Minimum: 34; Maximum: 63; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 43; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-SW-12000-18000-SPDT

**12000–18000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1 dB (typisch)**

12000–18000 MHz; Einfügedämpfung 1 dB (typisch); Isolation 38 dB (typisch); P0.2dB 44 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 1; Maximum: 1.2; Einheit: dB

**Isolation:** Minimum: 36; Typisch: 38; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 44; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-32000-38000-SPDT

### 32000–38000 MHz SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1 dB (typisch)

32000–38000 MHz; Einfügedämpfung 1 dB (typisch); Isolation 20 dB (typisch); P0.2dB 42 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 32000; Maximum: 38000; Wert: 32000–38000; Einheit: MHz

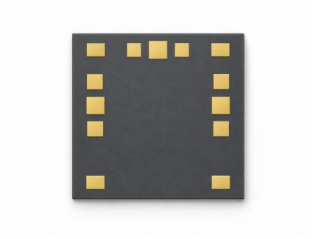
**Einfügedämpfung:** Typisch: 1; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 42; Einheit: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-2000-18000-SPDT

### 2000–18000 MHz SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.9 dB (typisch)

2000–18000 MHz; Einfügedämpfung 0.9 dB (typisch); Isolation 23 dB (typisch); P0.2dB 37 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

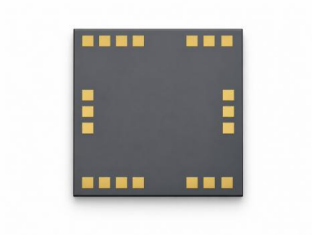
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.9; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 23; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 37; Einheit: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SP3T-D

### 100–20000 MHz GaAs SP3T-MMIC-Schalter als Bare Die — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Isolation (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung (100–2000 MHz):** Maximum: 1.4; Wert: f = 100–2000 MHz; Einheit: dB

**Einfügedämpfung (2000–20000 MHz):** Maximum: 2.8; Wert: f = 2000–20000 MHz; Einheit: dB

**Isolation (100–2000 MHz):** Maximum: 65; Wert: f = 100–2000 MHz; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

### 100–20000 MHz GaAs SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 1.6 dB (typisch)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung 1.6 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz; TA = +25 °C

**Einfügedämpfung:** Typisch: 1.6; Einheit: dB; TA = +25 °C

**Isolation:** Typisch: 45; Einheit: dB; TA = +25 °C

**Ruhestrom der negativen Versorgung:** Typisch: 0.0012; Einheit: A

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-8000-12000-SPDT

### 8000–12000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.9 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Einfügedämpfung 0.9 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch); P0.2dB 46 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

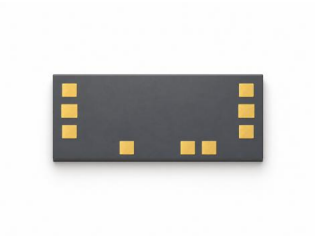
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.9; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 45; Maximum: 50; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 46; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SPST-D

### 100–20000 MHz GaAs SPST-MMIC-Schalter als Bare Die — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Einfügedämpfung ≤ 1.2 dB; Isolation 60 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Maximum: 1.2; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 60; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR (leitend):** Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-2700-3500-SPDT

### 2700–3500 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.7 dB (typisch)

2700–3500 MHz; Einfügedämpfung 0.7 dB (typisch); Isolation 41 dB (typisch); P0.2dB 51 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

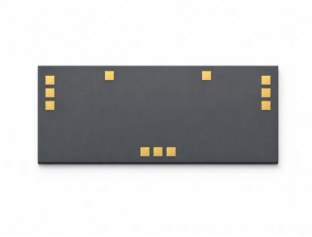
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.7; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 41; Maximum: 43; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 51; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-6000-SPDT

### 100–6000 MHz GaN SPDT-MMIC-Schalter als Bare Die — IL 0.7 dB (typisch)

100–6000 MHz; Einfügedämpfung 0.7 dB (typisch); Isolation 45 dB (typisch); P0.2dB 47 dBm (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 6000; Wert: 100–6000; Einheit: MHz

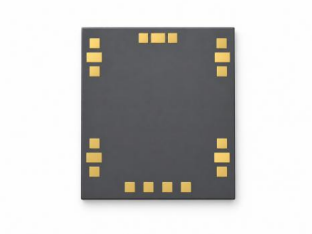
**Einfügedämpfung:** Typisch: 0.7; Maximum: 0.8; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 45; Einheit: dB

**Eingangsleistung bei 0.2 dB Kompression:** Typisch: 47; Einheit: dBm

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SP4T-D

### 100–20000 MHz GaAs SP4T-MMIC-Schalter als Bare Die — IL −2 dB (typisch)

100–20000 MHz; Einfügedämpfung -2 dB (typisch); Isolation -50 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

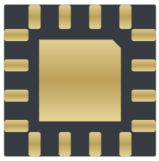
**Einfügedämpfung:** Typisch: -2; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: -50; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SPST-C

**100–20000 MHz RF-Schalter-IC — SPST; TTL**

100–20000 MHz; SPST; Einfügedämpfung -1.8 dB (typisch); Isolation 60 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

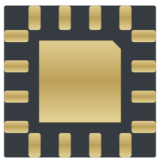
**Einfügedämpfung:** Symbol: IL; Typisch: -1.8; Einheit: dB

**Isolation:** Symbol: ISO; Typisch: 60; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR (leitend):** Typisch: 1.14

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SP3T-C

**100–20000 MHz RF-Schalter-IC — SP3T; TTL**

100–20000 MHz; SP3T; Einfügedämpfung -3.1 dB (typisch); Isolation 50 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

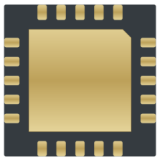
**Einfügedämpfung:** Symbol: IL; Typisch: -3.1; Einheit: dB

**Isolation:** Symbol: ISO; Typisch: 50; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR (leitend):** Typisch: 1.14

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-SW-100-20000-SP4T-C

**100–20000 MHz RF-Schalter-IC — SP4T; TTL**

100–20000 MHz; SP4T; Einfügedämpfung -2.6 dB (typisch); Isolation -50 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

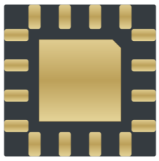
**Einfügedämpfung:** Symbol: IL; Typisch: -2.6; Einheit: dB

**Isolation:** Symbol: ISO; Typisch: -50; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-SW-100-20000-SPDT-C

**100–20000 MHz RF-Schalter-IC — SPDT; TTL**

100–20000 MHz; SPDT; Einfügedämpfung -2.2 dB (typisch); Isolation -45 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 20000; Wert: 100–20000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Symbol: IL; Typisch: -2.2; Einheit: dB

**Isolation:** Symbol: ISO; Typisch: -45; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.22

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

## HF-Beamformer-ICs



### LCI-BF-14000-18000-4CH

**14000–18000 MHz Vierkanal-SiGe-T/R-Beamformer als Bare Die**

Phasenschritt: 5.625 °; Dämpfungsbereich: 0–31.5 dB; Schaltzeit: 100 ns (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 5 × 6.2 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

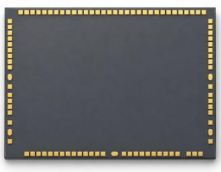
**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.8

**RMS-Phasenfehler:** Maximum: 3; Einheit: °

**RMS-Dämpfungsfehler:** Maximum: 0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-BF-8000-12000-2CH

**8000–12000 MHz Zweikanal-Si-T/R-Beamformer als Bare Die**

Phasenschritt: 5.625 ° (typisch); Dämpfungsschritt: 0.5 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

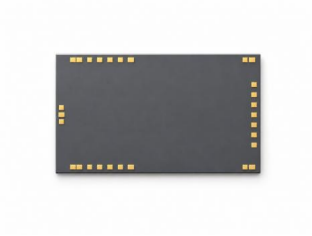
**Auflösung der Phasensteuerung:** Wert: 6; Einheit: bit

**Auflösung der Dämpfungssteuerung:** Wert: 6; Einheit: bit

**Phasenstellbereich:** Minimum: 0; Maximum: 360; Einheit: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-BF-3700-5000-2CH

**3700–5000 MHz Zweikanal-GaAs-MMIC zur Phasen- und Dämpfungssteuerung als Bare Die — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT**

3700–5000 MHz; Einfügedämpfung -13 dB (typisch); RMS-Dämpfungsfehler über 64 Zustände 0.2 dB (typisch); RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 2 ° (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 3700; Maximum: 5000; Wert: 3700–5000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: -13; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Maximum: 31.5; Einheit: dB

**RMS-Dämpfungsfehler über 64 Zustände:** Typisch: 0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Produktdetails Produktdatenblatt

## HF-Phasenschieber-ICs



### LCI-PS-1200-1400-6B-D

**1200–1400 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die**

RMS-Phasenfehler: 0.5 ° (Minimum) / 0.7 ° (typisch) / 1 ° (Maximum); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum); Einfügedämpfung: ≈5 dB. Chipabmessungen: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 1200; Maximum: 1400; Wert: 1200–1400; Einheit: MHz

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Minimum: 0.5; Typisch: 0.7; Maximum: 1; Einheit: °

**Phasenbedingte Amplitudenänderung:** Typisch: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-PS-5000-6000-6B

**5000–6000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die**

RMS-Phasenfehler: 1 ° (typisch); Einfügedämpfung: 7 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

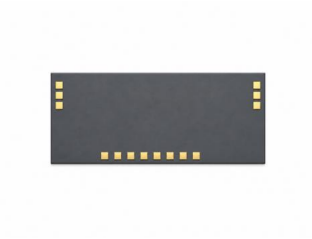
**Einfügedämpfung:** Typisch: 7; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1; Einheit: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-2700-3500-6B

### 2700–3500 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1 ° (typisch); Einfügedämpfung: 5.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 5.5; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1; Einheit: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-15000-23000-6B

### 15000–23000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.4 ° (typisch); Einfügedämpfung: 9.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 15000; Maximum: 23000; Wert: 15000–23000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 9.5; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1.4; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-25000-33000-6B

### 25000–33000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.6 ° (typisch); Einfügedämpfung: 9.5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 25000; Maximum: 33000; Wert: 25000–33000; Einheit: MHz

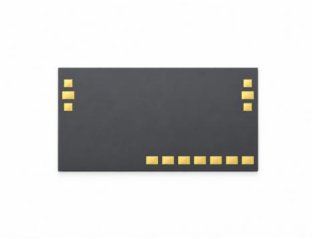
**Einfügedämpfung:** Typisch: 9.5; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1.6; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-14000-18000-6B-D

### 14000–18000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.2 ° (typisch); Einfügedämpfung: 7 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 7; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1.2; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-900-1400-6B-D

### 900–1400 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 1.5 ° (typisch); Einfügedämpfung: 5 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 900; Maximum: 1400; Wert: 900–1400; Einheit: MHz

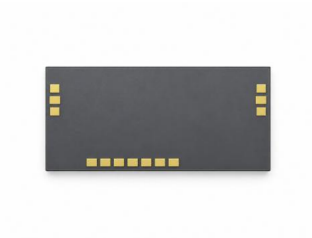
**Einfügedämpfung:** Typisch: 5; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 1.5; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-1200-1600-6B-D

### 1200–1600 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 0.8 ° (typisch); Einfügedämpfung: 4.3 dB (typisch); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 1200; Maximum: 1600; Wert: 1200–1600; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 4.3; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 0.8; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-2000-8000-6B

### 2000–8000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Phasenschieber als Bare Die

RMS-Phasenfehler: 2.2 ° (typisch) / 3 ° (Maximum); Einfügedämpfung: 10 dB (typisch) / 11.5 dB (Maximum); Phasenstellbereich: 5.625 ° (Minimum) / 354.375 ° (Maximum). Chipabmessungen: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 8000; Wert: 2000–8000; Einheit: MHz

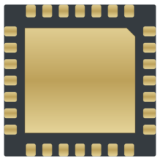
**Einfügedämpfung:** Typisch: 10; Maximum: 11.5; Einheit: dB

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**RMS-Phasenfehler:** Typisch: 2.2; Maximum: 3; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-900-1400-6B-C

### 900–1400 MHz Digitales Phasenschieber-IC — 6-bit; RMS 1.5° (typisch)

900–1400 MHz; RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 1.5 ° (typisch); Phasenbedingte Amplitudenänderung ±0.4 dB (typisch); Eingangs-VSWR 1.5 (typisch); Ausgangs-VSWR 1.4 (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 900; Maximum: 1400; Wert: 900–1400; Einheit: MHz

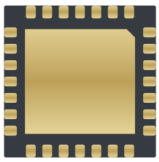
**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**Einfügedämpfung:** Typisch: -5.4; Einheit: dB

**RMS-Phasenfehler über 64 Zustände:** Typisch: 1.5; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-PS-1200-1400-6B-C

### 1200–1400 MHz Digitales Phasenschieber-IC — 6-bit; RMS 0.7° (typisch)

1200–1400 MHz; RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 0.7 ° (typisch); Phasenbedingte Amplitudenänderung ±0.5 dB (typisch); Eingangs-VSWR 1.4 (typisch); Ausgangs-VSWR 1.4 (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 1400; Wert: 1200–1400; Einheit: MHz

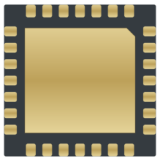
**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**Einfügedämpfung:** Typisch: -5.4; Einheit: dB

**RMS-Phasenfehler über 64 Zustände:** Typisch: 0.7; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-PS-1200-1600-6B-C

**1200–1600 MHz Digitales Phasenschieber-IC — 6-bit; RMS 0.8° (typisch)**

1200–1600 MHz; RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 0.8 ° (typisch); Phasenbedingte Amplitudenänderung ±0.4 dB (typisch); Eingangs-VSWR 1.4 (typisch); Ausgangs-VSWR 1.4 (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 1200; Maximum: 1600; Wert: 1200–1600; Einheit: MHz

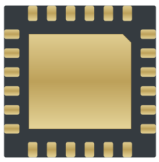
**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Maximum: 354.375; Einheit: °

**Einfügedämpfung:** Typisch: -4.7; Einheit: dB

**RMS-Phasenfehler über 64 Zustände:** Typisch: 0.8; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-PS-14000-18000-6B-C

**14000–18000 MHz Digitales Phasenschieber-IC — 6-bit; RMS 1.2° (typisch)**

14000–18000 MHz; RMS-Phasenfehler über 64 Zustände 1.2 ° (typisch); Phasenbedingte Amplitudenänderung ±0.3 dB (typisch); Eingangs-VSWR 1.5 (typisch); Ausgangs-VSWR 1.3 (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Phasenstellbereich:** Minimum: 5.625; Einheit: °

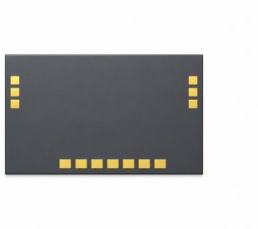
**Einfügedämpfung:** Typisch: -7.4; Einheit: dB

**RMS-Phasenfehler über 64 Zustände:** Typisch: 1.2; Einheit: °

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

## Digitale HF-Dämpfungsglieder als IC



### LCI-ATT-14000-18000-6B-D

**14000–18000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Dämpfungsglied als Bare Die**

RMS-Dämpfungsfehler: 0.3 dB (typisch); Einfügedämpfung: 4 dB (Maximum); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum). Chipabmessungen: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

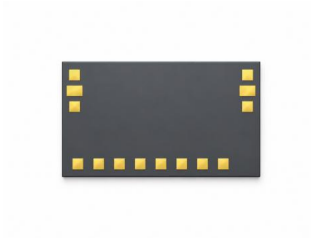
**Einfügedämpfung:** Maximum: 4; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**RMS-Dämpfungsfehler:** Typisch: 0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-ATT-DC-8000-6B

### DC–8000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Dämpfungsglied als Bare Die

RMS-Dämpfungsfehler: 0.2 dB (typisch); Einfügedämpfung: 1.6 dB (typisch); Dämpfungsbereich: 0.5 dB (Minimum) / 31.5 dB (Maximum). Chipabmessungen: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 8000; Wert: DC–8000; Einheit: MHz

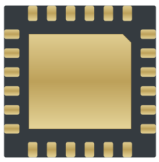
**Einfügedämpfung:** Typisch: 1.6; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**RMS-Dämpfungsfehler:** Typisch: 0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-ATT-100-8000-6B

### 100–8000 MHz Digitales Stufendämpfungs-IC — 6-bit; 0.5 dB

100–8000 MHz; Dämpfungsbereich 0.5–31.5 dB; Dämpfungsgenauigkeit 0.2 dB (typisch); Einfügedämpfung 2 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 100; Maximum: 8000; Wert: 100–8000; Einheit: MHz

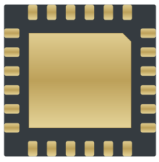
**Einfügedämpfung:** Typisch: 2; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**Dämpfungsgenauigkeit:** Typisch: 0.2; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-ATT-14000-18000-6B-C

### 14000–18000 MHz Digitales Stufendämpfungs-IC — 6-bit; 0.5 dB

14000–18000 MHz; Dämpfungsbereich 0.5–31.5 dB; Dämpfungsgenauigkeit 0.3 dB (typisch); Einfügedämpfung 2 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 14000; Maximum: 18000; Wert: 14000–18000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 2; Einheit: dB

**Dämpfungsbereich:** Minimum: 0.5; Maximum: 31.5; Einheit: dB

**Dämpfungsgenauigkeit:** Typisch: 0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TTD-5000-6000-4B

### 5000–6000 MHz 4-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 92.5 ps (typisch) (T1; t_nom = 92.59 ps); Zeitverzögerung: 737 ps (typisch) (T4; t_nom = 740.74 ps); Einfügedämpfung: 12 dB (typisch) / 13 dB (Maximum). Chipabmessungen: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 5000; Maximum: 6000; Wert: 5000–6000; Einheit: MHz

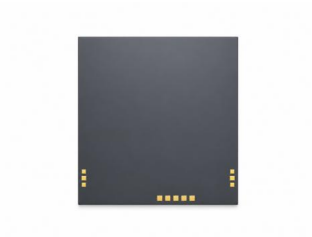
**Einfügedämpfung:** Typisch: 12; Maximum: 13; Einheit: dB

**Zeitverzögerung (T1):** Typisch: 92.5; Wert: T1; t_nom = 92.59 ps; Einheit: ps

**Zeitverzögerung (T2):** Typisch: 184; Wert: T2; t_nom = 185.185 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TTD-8500-10500-4B

### 8500–10500 MHz 4-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 52.7 ps (typisch) (T1; t_nom = 52 ps); Zeitverzögerung: 416 ps (typisch) (T4; t_nom = 416 ps); Einfügedämpfung: 12 dB (typisch) / 13 dB (Maximum). Chipabmessungen: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8500; Maximum: 10500; Wert: 8500–10500; Einheit: MHz

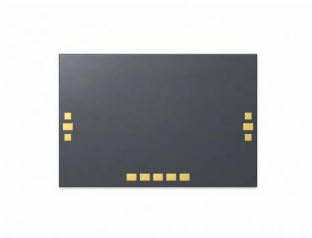
**Einfügedämpfung:** Typisch: 12; Maximum: 13; Einheit: dB

**Zeitverzögerung (T1):** Typisch: 52.7; Wert: T1; t_nom = 52 ps; Einheit: ps

**Zeitverzögerung (T2):** Typisch: 102; Wert: T2; t_nom = 104 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TTD-8000-12000-3B

### 8000–12000 MHz 3-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 25 ps (typisch) (T1; t_nom = 25 ps); Zeitverzögerung: 102 ps (typisch) (T3; t_nom = 100 ps); Einfügedämpfung: 6 dB (typisch) / 7 dB (Maximum). Chipabmessungen: 3 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

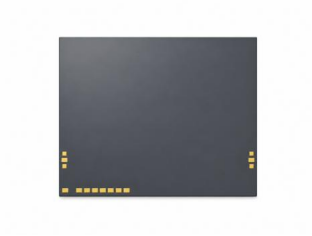
**Einfügedämpfung:** Typisch: 6; Maximum: 7; Einheit: dB

**Zeitverzögerung (T1):** Typisch: 25; Wert: T1; t_nom = 25 ps; Einheit: ps

**Zeitverzögerung (T2):** Typisch: 49.5; Wert: T2; t_nom = 50 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TTD-200-2000-6B

### 200–2000 MHz 6-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 25 ps (typisch) (T1; t_nom = 25 ps); Zeitverzögerung: 800 ps (typisch) (T6; t_nom = 800 ps); Einfügedämpfung: 11 dB (Maximum). Chipabmessungen: 5 × 4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 200; Maximum: 2000; Wert: 200–2000; Einheit: MHz

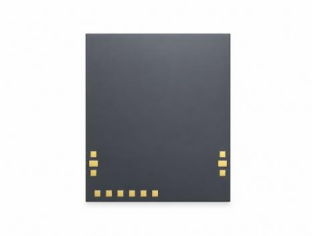
**Einfügedämpfung:** Maximum: 11; Einheit: dB

**Zeitverzögerung (T1):** Typisch: 25; Einheit: ps; Hinweise: T1; t_nom = 25 ps

**Zeitverzögerung (T2):** Typisch: 50; Einheit: ps; Hinweise: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCI-TTD-7000-13000-3B

### 7000–13000 MHz 3-Bit-GaAs-MMIC-Zeitverzögerung als Bare Die

Zeitverzögerung: 52 ps (typisch) (T1; t_nom = 52 ps); Zeitverzögerung: 208 ps (typisch) (T3; t_nom = 208 ps); Einfügedämpfung: 9 dB (typisch). Chipabmessungen: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: 9; Einheit: dB

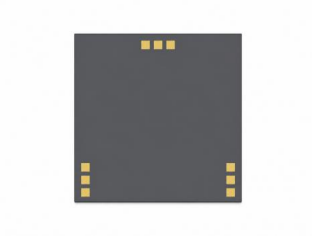
**Zeitverzögerung (T1):** Typisch: 52; Wert: T1; t_nom = 52 ps; Einheit: ps

**Zeitverzögerung (T2):** Typisch: 104; Wert: T2; t_nom = 104 ps; Einheit: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Produktdetails Produktdatenblatt

# Integrierte passive HF-Bauelemente



## LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

### 2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2 × 2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-3700-5000-2WAY

### 3700–5000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 3700; Maximum: 5000; Wert: 3700–5000; Einheit: MHz

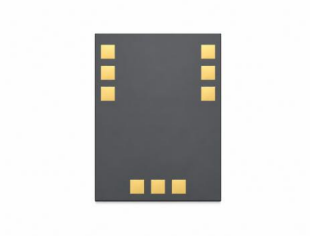
**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-500-2700-2WAY

### 500–2700 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 14 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 500; Maximum: 2700; Wert: 500–2700; Einheit: MHz

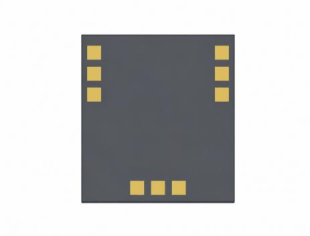
**Isolation:** Typisch: 14; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-800-2000-2WAY

### 800–2000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 800; Maximum: 2000; Wert: 800–2000; Einheit: MHz

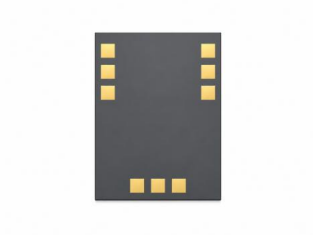
**Isolation:** Typisch: 18; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-1000-4000-2WAY

### 1000–4000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 18 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.4 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.4 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 1000; Maximum: 4000; Wert: 1000–4000; Einheit: MHz

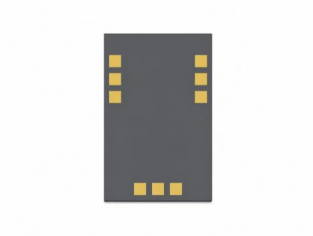
**Isolation:** Typisch: 18; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.4

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.4

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-2000-6000-2WAY

### 2000–6000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

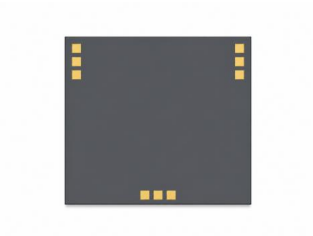
**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

### 2000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2000; Maximum: 18000; Wert: 2000–18000; Einheit: MHz

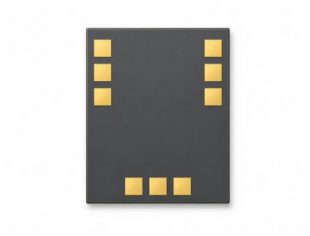
**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-2700-3500-2WAY

### 2700–3500 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

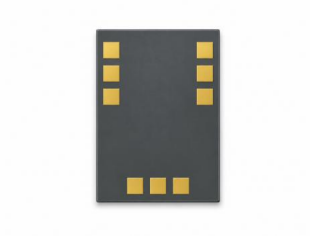
**Isolation:** Typisch: 30; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.1

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-5000-7000-2WAY

### 5000–7000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.1 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 5000; Maximum: 7000; Wert: 5000–7000; Einheit: MHz

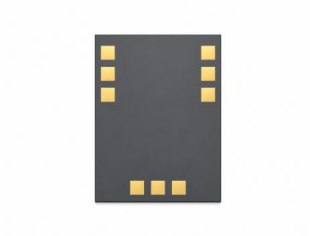
**Isolation:** Typisch: 25; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.1

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-5000-13000-2WAY

### 5000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 5000; Maximum: 13000; Wert: 5000–13000; Einheit: MHz

**Isolation:** Typisch: 25; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-6000-18000-2WAY

### 6000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 6000; Maximum: 18000; Wert: 6000–18000; Einheit: MHz

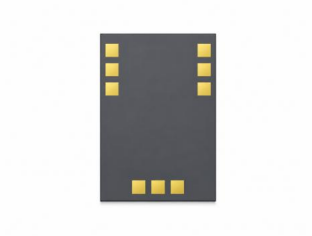
**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-7000-13000-2WAY

### 7000–13000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 7000; Maximum: 13000; Wert: 7000–13000; Einheit: MHz

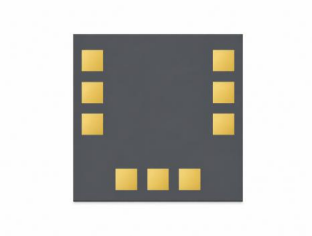
**Isolation:** Typisch: 25; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-8000-12000-2WAY

### 8000–12000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

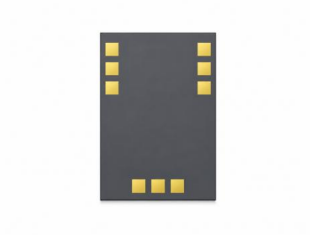
**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-10000-20000-2WAY

### 10000–20000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 30 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.2 (typisch). Chipabmessungen: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 10000; Maximum: 20000; Wert: 10000–20000; Einheit: MHz

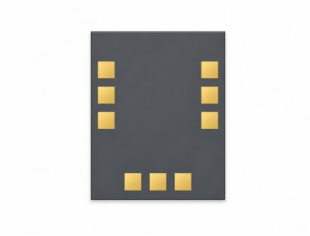
**Isolation:** Typisch: 30; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-12000-18000-2WAY

### 12000–18000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 25 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.2 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.1 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 12000; Maximum: 18000; Wert: 12000–18000; Einheit: MHz

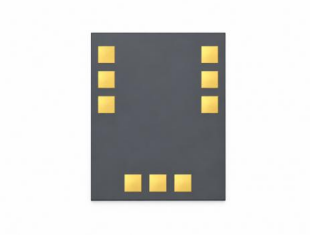
**Isolation:** Typisch: 25; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.2

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.1

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCDIV-30000-40000-2WAY

### 30000–40000 MHz GaAs-IPD-Leistungsteilerchip mit 2 Ausgängen und 0° Phase

Isolation: 20 dB (typisch); Eingangs-VSWR: 1.3 (typisch); Ausgangs-VSWR: 1.3 (typisch). Chipabmessungen: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 30000; Maximum: 40000; Wert: 30000–40000; Einheit: MHz

**Isolation:** Typisch: 20; Einheit: dB

**Eingangs-VSWR:** Typisch: 1.3

**Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.3

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.2 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 0; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.2

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 1; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 2; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 3; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A4

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 4 dB

Dämpfung: 4 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 4; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 8; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A16

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 16 dB

Dämpfung: 16 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 16; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.6 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 0; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.4 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 1; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.4

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 2; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.35

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 3; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.35

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A5

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 5 dB

Dämpfung: 5 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 5; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A6

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 6 dB

Dämpfung: 6 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 6; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.35

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

**Dämpfung:** Wert: 8; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCATT-DC-30000-A10

### DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 10 dB

Dämpfung: 10 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

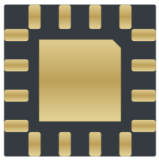
**Dämpfung:** Wert: 10; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Wert: 1.3

**Dämpfungswelligkeit:** Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCXOV-DC-40000-C

**DC–40000 MHz Gehäuste RF-Kreuzung — ISO 30 dB (typisch)**

DC–40000 MHz; Einfügedämpfung -1.4 dB (typisch); Isolation 30 dB (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: DC; Maximum: 40000; Wert: DC–40000; Einheit: MHz

**Einfügedämpfung:** Typisch: -1.4; Einheit: dB

**Isolation:** Typisch: 30; Einheit: dB

**Ein-/Ausgangs-VSWR:** Typisch: 1.2

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

## Mischer- und Umsetzer-ICs



### LCI-MIX-500-2000-D

**500–2000 MHz Passiver doppelt symmetrischer GaAs-MMIC-Mischer als Bare Die**

Konversionsverlust: 9 dB (typisch); LO-Leistung: 15 dBm; Betriebsfrequenz (IF): 0 MHz (Minimum) / 900 MHz (Maximum) / DC–900 MHz. Chipabmessungen: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 500; Maximum: 2000; Wert: 500–2000 (RF / LO); Einheit: MHz

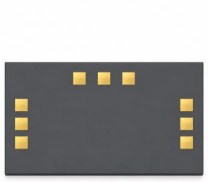
**Betriebsfrequenz (IF):** Minimum: 0; Maximum: 900; Wert: DC–900; Einheit: MHz

**Konversionsverlust:** Typisch: 9; Einheit: dB

**Isolation (LO / RF):** Typisch: 45; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-MIX-7000-10000-D

**7000–10000 MHz Passiver doppelt symmetrischer GaAs-MMIC-Mischer als Bare Die**

Konversionsverlust: 8.5 dB (typisch); LO-Leistung: 14 dBm; Betriebsfrequenz (IF): 1400 MHz (Minimum) / 3000 MHz (Maximum) / 1400–3000 MHz. Chipabmessungen: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

**Betriebsfrequenz:** Minimum: 7000; Maximum: 10000; Wert: 7000–10000 (RF); Einheit: MHz

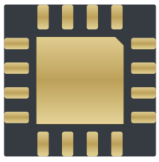
**Betriebsfrequenz (LO):** Minimum: 5000; Maximum: 9000; Wert: 5000–9000; Einheit: MHz

**Betriebsfrequenz (IF):** Minimum: 1400; Maximum: 3000; Wert: 1400–3000; Einheit: MHz

**Konversionsverlust:** Typisch: 8.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-MIX-500-2000-C

**500–2000 MHz Gehäuster passiver doppelt symmetrischer Mischer — LO +14 dBm; IL -9 dB (typisch)**

500–2000 MHz; IF DC–900 MHz; Umsetzverlust -9 dB (typisch); LOin = 14 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 500; Maximum: 2000; Wert: 500–2000; Einheit: MHz

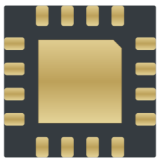
**IF-Frequenzbereich:** Minimum: DC; Maximum: 900; Einheit: MHz

**Umsetzverlust:** Symbol: IL; Typisch: -9; Einheit: dB

**LO-RF-Isolation:** Symbol: ISOL-R; Typisch: -40; Einheit: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



### LCI-MIX-7000-10000-C

**7000–10000 MHz Gehäuster passiver doppelt symmetrischer Mischer — LO +14 dBm; IL -9 dB (typisch)**

7000–10000 MHz; IF 1400–3400 MHz; Umsetzverlust -9 dB (typisch); LOin = 14 dBm.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 7000; Maximum: 10000; Wert: 7000–10000; Einheit: MHz

**IF-Frequenzbereich:** Minimum: 1400; Maximum: 3400; Einheit: MHz

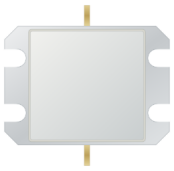
**Umsetzverlust:** Symbol: IL; Typisch: -9; Einheit: dB

**LO-RF-Isolation:** Symbol: ISOL-R; Typisch: -40; Einheit: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt

## RF-Leistungstransistoren



### LCT-5700-7100-PS51T

**5700–7100 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 51 dBm (typisch)**

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 11 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5700; Maximum: 7100; Wert: 5700–7100; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 50.5; Typisch: 51; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 10.5; Typisch: 11; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 40; Typisch: 45; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2700-3500-PS56p5T

**2700–3500 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 56.5 dBm (typisch)**

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13.5 dB (typisch); PAE 55 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 56; Typisch: 56.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 13; Typisch: 13.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 50; Typisch: 55; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-5300-5900-PS56p5T

**5300–5900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 56.5 dBm (typisch)**

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12.5 dB (typisch); PAE 45 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 5300; Maximum: 5900; Wert: 5300–5900; Einheit: MHz

**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 56; Typisch: 56.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 12; Typisch: 12.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 40; Typisch: 45; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2700-3900-PS48p5T

**2700–3900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 48.5 dBm (typisch)**

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12.5 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3900; Wert: 2700–3900; Einheit: MHz

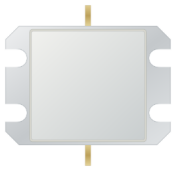
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 48; Typisch: 48.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 12; Typisch: 12.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2700-3500-PS53p5T

**2700–3500 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 53.5 dBm (typisch)**

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13.5 dB (typisch); PAE 65 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2700; Maximum: 3500; Wert: 2700–3500; Einheit: MHz

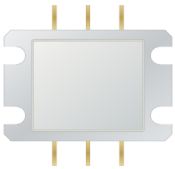
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 53; Typisch: 53.5; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 13; Typisch: 13.5; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 60; Typisch: 65; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2300-3900-PS50T

**2300–3900 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 50 dBm (typisch)**

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 12 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2300; Maximum: 3900; Wert: 2300–3900; Einheit: MHz

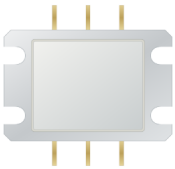
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 49; Typisch: 50; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 11; Typisch: 12; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2600-3700-PS49T

**2600–3700 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 49 dBm (typisch)**

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 13 dB (typisch); PAE 50 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2600; Maximum: 3700; Wert: 2600–3700; Einheit: MHz

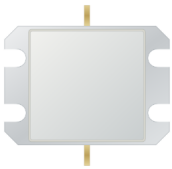
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 48; Typisch: 49; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 12; Typisch: 13; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Minimum: 45; Typisch: 50; Einheit: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-8500-9600-PS51T

### 8500–9600 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 51 dBm (typisch)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 9 dB (typisch); PAE 38 % (typisch).

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 8500; Maximum: 9600; Wert: 8500–9600; Einheit: MHz

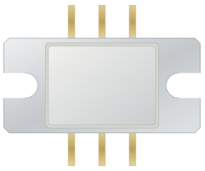
**Sättigungsausgangsleistung:** Minimum: 50; Typisch: 51; Einheit: dBm

**Leistungsverstärkung:** Minimum: 8; Typisch: 9; Einheit: dB

**Leistungsaddierte Effizienz:** Typisch: 38; Einheit: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2000-6000-PO45p51T

### 2000–6000 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (typisch)

2000–6000 MHz; Referenz-Ausgangsleistung 45.51 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 19.51 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 39.82 % (typisch) @ 6000 MHz.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

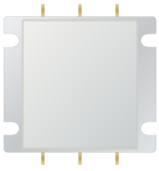
**Referenz-Ausgangsleistung:** Typisch: 45.51; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 19.51; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

**Drain-Wirkungsgrad:** Symbol: ηD; Typisch: 39.82; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-700-6200-PS49T

### 700–6200 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (typisch)

700–6200 MHz; Sättigungsausgangsleistung 49 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 7 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 35 % (typisch) @ 6000 MHz.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 700; Maximum: 6200; Wert: 700–6200; Einheit: MHz

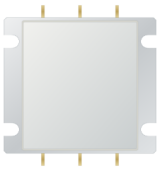
**Sättigungsausgangsleistung:** Symbol: Psat; Typisch: 49; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 7; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

**Drain-Wirkungsgrad:** Symbol: ηD; Typisch: 35; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Produktdetails Produktdatenblatt



## LCT-2000-6200-PO50p1T

### 2000–6200 MHz GaN Intern angepasster Leistungstransistor — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (typisch)

2000–6200 MHz; Referenz-Ausgangsleistung 50.1 dBm (typisch); Leistungsverstärkung 8.6 dB (typisch); Drain-Wirkungsgrad 52.4 % (typisch) @ 6000 MHz.

**Betriebsfrequenz:** Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6200; Wert: 2000–6200; Einheit: MHz

**Referenz-Ausgangsleistung:** Typisch: 50.1; Einheit: dBm; Hinweise: f = 6000 MHz

**Leistungsverstärkung:** Typisch: 8.6; Einheit: dB; Hinweise: f = 6000 MHz

**Drain-Wirkungsgrad:** Symbol: ηD; Typisch: 52.4; Einheit: %; Hinweise: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Produktdetails Produktdatenblatt

**Dokumenthinweis**

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.